PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION	United States Patent and Trademark
	Office
(PCT Rule 61.2)	(Box PCT) Crystal Plaza 2
	Washington, DC 20231
	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of mailing (day/month/year) 03 February 1999 (03.02.99)	in its capacity as elected Office
International application No.	Applicant's or agent's file reference
PCT/JP98/03033	ZE-684
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
06 July 1998 (06.07.98)	04 July 1997 (04.07.97)
Applicant	
KODEMURA, Junji	
The designated Office is hereby notified of its election made:	
X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:	
14 January 1999 (14.01.99)	
in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	
2. The election X was	
was not	
made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).	
	· ·
The International Burnary of Manage	Authorized officer
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes	K. Takeda
1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

C09J 123/26, 165/00, 171/12, H01B 1/20 // (C09J 123/26, 163:00) (C09J 165/00, 163:00) (C09J 171/12, 163:00)

(11) 国際公開番号

WO99/01519

(43) 国際公開日

(81) 指定国

1999年1月14日(14.01.99)

JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE,

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/03033

JP

A1

(22) 国際出願日

1998年7月6日(06.07.98)

(30) 優先権データ

特願平9/195066

1997年7月4日(04.07.97)

添付公開書類

国際調査報告書

DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 日本ゼオン株式会社(NIPPON ZEON CO., LTD.)[JP/JP] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

小出村順司(KODEMURA, Junji)[JP/JP]

〒210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1号

日本ゼオン株式会社 総合開発センター内 Kanagawa (JP)

(74) 代理人

弁理士 西川繁明(NISHIKAWA, Shigeaki)

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里三丁目43番8号

ビジュアル・シティー401号 Tokyo, (JP)

(54)Title: ADHESIVE FOR SEMICONDUCTOR COMPONENTS

(54)発明の名称 半導体部品接着剤

(57) Abstract

An adhesive for semiconductor components, comprising as a substrate polymer at least one cyclic thermoplastic polymer having a number average molecular weight of 1,000 to 500,000 and selected from the group consisting of cyclic olefin polymers (a) and aromatic condensation polymers (b) having repeating units of an aromatic ring in the main chain; an adhesive sheet prepared from the adhesive; a semiconductor component package made by using the adhesive; and a process for preparing the package.

(57)要約

シ

(a)環状オレフィン系重合体及び(b)主鎖中に芳香環の繰り返し単位を有する芳香族縮合系重合体からなる群より選ばれる少なくとも一種の数平均分子量が1,000~500,000環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする半導体部品接着剤、該接着剤からなる接着シート、該接着剤を用いた半導体部品パッケージ、及び該パッケージの製造方法。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

> スーダン スウェーデン シンガポール

明細書

半導体部品接着剤

5 〈技術分野〉

本発明は、半導体部品接着剤に関し、さらに詳しくは、環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする、保存安定性、接着性、耐熱性、耐湿性、低吸水性、誘電特性(低誘電率及び低誘電正接)、生産性、機械的強度、及び長期信頼性に優れた半導体部品接着剤に関する。また、本発明は、該接着剤を用いて、半導体部品と配線基板とを接合させる工程を含む半導体部品パッケージの製造方法に関する。さらに、本発明は、該接着剤によって接着された半導体部品パッケージに関する。

15 < 背景技術 >

10

近年、高度情報化社会の急激な進展に伴い、コンピュータや通信機器などの情報処理機器の処理能力の向上、即ち、高速化が迫られており、また、携帯可能なように、小型化、軽量化が必要とされている。

- 20 こうした要求のなかで、情報処理速度を高速化するためには、機器に搭載される半導体部品の実装において、LSI、メモリ、その他の受動または能動部品などの相互接続配線をできる限り短くして高密度化することが有効である。この手法は、情報処理機器の小型化・軽量化にも有効である。
- 25 半導体部品の相互接続配線距離を短縮する手段としては、半導体 チップを直接基板に搭載するベアチップ実装があるが、中でも半導

10

15

20

体チップ(半導体集積回路素子)の電極と配線基板の電極とをバンプ(微小金属突起;例えば、AUバンプやハンダバンプ)を介して直接接合するフリップチップボンディング(FC)は、最も有効な方法である。

従来、フリップチップボンディングは、Sn-Pb系ハンダ等の金属材料を利用したメタラジカル接合が主流であった。より具体的に、配線基板上に半導体チップを搭載する場合、配線基板の導体パターン上に半導体チップを載せて、ハンダ付け接合を行っている。ハンダ付け工程では、リフローソルダリングに続いてフローソルダリングを行う必要があるため、工程が煩雑であり、また、耐熱性のない部品を搭載することができない。さらに、半導体部品の接着・接合において、接合部の微小化が進んでいるため、ハンダ接合での対応が困難となっている。

そこで、電子機器の高密度実装化や小型化、電気性能の向上、製造コストの低減、組立の自動化などの要請に応えるため、非メタラジカル接合を含む様々な表面実装技術が開発されている。例えば、半導体チップにバンプを形成し、配線基板上には絶縁樹脂層を形成し、両者を加熱・圧着することにより、バンプを介してダイレクトに半導体チップの電極と配線基板の電極を最短距離で接合する方法が実用化されている。絶縁樹脂層は、通常、エポキシ樹脂などの接着性を有する熱硬化性樹脂により形成されており、電極間の接合と同時に、樹脂の硬化による半導体チップと配線基板との接着が行われる。

また、半導体チップにバンプを形成し、配線基板上の導体パター 25 ンとの間隙に異方性導電膜を介在させ、押えつけることにより、半 導体チップのバンプと配線基板上の導体パターンとを圧接接合し、

10

15

20

25

電気的接続を形成する方法が開発されている。異方性導電膜は、通常、結着樹脂中に、金属微粒子や表面に導電膜を設けた樹脂ボール(微粒子)などの導電性充填剤を分散させた異方性導電材から形成されている。異方性導電材を用いた接合機構は、異方性導電材中に分散された導電性充填剤がある確率を持って接続端子上に存在し、接合時に熱と圧力を加えることにより、導電性充填剤が端子間で点接触から面接触に近い状態にまで押しつぶされ、それによって、導電性を得ると共に、被着体を充分に接着し、安定した接合を行うというものである。導電性充填剤の充填量が多すぎると、端子間リークや接着力の低下を招き、逆に、少なすぎると、端子間りが生じる。すなわち、導電性充填剤の分散量を調整することにより、性方向の絶縁性と上限端子間の導電性とのバランスをとり、さらには、接着力の制御も行っている。

絶縁樹脂や異方性導電材などを用いた非メタラジカル接合は、ハンダ接合に比べて、比較的低温で接合することができるという利点がある。非メタラジカル接合による実装は、ハンダ接合に比べて接合対象の材質の制限が少なく、その適用範囲が広い。また、接合の低温度化により、部品及び基板に対する耐熱要求を緩和することができると共に、フラックス洗浄が不要であることから、実装コストの低減を図ることができる。

従来、非メタラジカル接合において、前記の絶縁樹脂や結着樹脂として、接着性及び耐熱性の観点から、熱硬化性樹脂及び紫外線硬化性樹脂が汎用されている。しかしながら、熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂を用いて接合すると、組立工程上で発生した接合不良によるリペア性に問題があった。すなわち、接合時の加熱・加圧や紫外線照射により、これらの樹脂が硬化すると、不良品をリペアする

10

15

20

25

ことが極めて困難である。仮に半導体チップを配線基板から剥離することができたとしても、硬化した樹脂の残渣を除去することは難しい。半導体パッケージの場合、一部の欠陥のために全体をスクラップすることは、コスト的に多大の損失となる。したがって、配線修理や半導体チップの交換、再使用などの技術の確立が求められている。

また、従来より、これらの用途においては、高温条件下での接続抵抗値の変動が小さいことから、特に熱硬化型のエポキシ樹脂には、大別して、予め主剤と硬化剤を混合しておく一液型と、使用時に主剤と硬化剤を混合する二液型とがある。しかし、主剤と硬化剤を予め混合したでするのを防止するために、冷凍保管が必要なものが大部分である。一液型エポキシ樹脂は、低温硬化のため、室温でのポットライフはせいぜい1日程度であり、冷凍保管をしても、そのポットライフは2~3ヵ月程度である。しかも、一液型エポキシ樹脂を冷凍保管をしても、そのポットライフは2~3ヵ月程度である。しかも、一液型エポキシ樹脂を冷凍保管をしても、使用時に室温に戻す必要があり、作業性が悪い。しかも、空温に戻す際に、一液型エポキシ樹脂が吸湿して、特性が劣化するという問題がある。

一方、主剤と硬化剤とを使用時に混合する二液型エポキシ樹脂の場合には、使用の都度、主剤と硬化剤とを混合しなければならず、作業性が悪いという問題がある。この種の接着剤による接合・接着においては、短時間に多くの部品を接合・接着するために、素早く確実に接着剤を塗布する塗布技術が重要である。通常は、スクリーン印刷法やディスペンサーによる吐出法が適用される。これらの方法を適用するに当って問題となるのは、塗斑の発生である。二液型

10

15

20

エポキシ樹脂は、塗布量のコントロールが困難であり、塗斑が発生 しやすく、安定した接着ができないという問題がある。

一液型及び二液型エポキシ樹脂の共通問題として、硬化させるまでの時間が長くかかること、すなわち、生産性が低いという問題がある。また、絶縁樹脂や異方性導電材は、フィルムまたはシートの形態で使用することが求められる場合があるが、エポキシ樹脂は、シートを形成する際に、タックフリーとなるように、部分的に硬化させる必要がある。このような部分的な硬化は、制御が難しく、しかも得られるシートの安定性や保存性に問題がある。

これに加えて、エポキシ樹脂は、接着性及び機械強度が十分ではなく、また、耐湿性、誘電特性、低不純物性に劣り、さらには、高温での誘電特性並びにその経時変化に問題がある。したがって、エポキシ樹脂は、高温及び高湿中で安定性と高信頼性を得るのは難しく、また、場合によっては、樹脂中の可動イオンが半導体部品に対し悪影響を与えることがある。

近年、環状オレフィンの繰り返し単位を有する熱可塑性ノルボルネン系樹脂が、耐熱性、耐湿性、誘電特性、低不純物性に優れる樹脂材料として注目されている。例えば、特開昭62-27412号公報には、テトラシクロドデセンとエチレンとの付加重合体などの環状オレフィン共重合体をアリルグリシジルエーテルや無水マレイン酸によってグラフト変性させた変性環状オレフィン共重合体が開示されている。しかし、従来、このような熱可塑性ノルボルネン系樹脂を半導体部品の実装における接着剤として使用することは提案されていなかった。

20

25

<発明の開示>

本発明の目的は、保存安定性、接着性、耐熱性、耐湿性、低吸水性、誘電特性、生産性、機械的強度、及び長期信頼性に優れた半導体部品接着剤を提供することにある。

また、本発明の目的は、このような諸特性に優れた接着剤を用いて、半導体部品と配線基板とを接合させる工程を含む半導体部品パッケージの製造方法を提供することにある。

さらに、本発明の目的は、このような諸特性に優れた接着剤により接合された半導体部品パッケージを提供することにある。

10 本発明者は、前記従来技術の問題点を克服するために鋭意研究した結果、(a)環状オレフィン系重合体及び(b)主鎖中に芳香環の繰り返し単位を有する芳香族縮合系重合体からなる群より選ばれる少なくとも一種の数平均分子量が1,000~500,000環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とすることにより、前記諸特性に優れた半導体部品用の接着剤の得られることを見出した。

本発明で使用する環構造含有熱可塑性重合体は、金属や他の樹脂などとの密着性を向上させるために、官能基、特に極性基を有するものであることが望ましい。

本発明の接着剤は、通常、接着剤溶液または接着フィルム(シートを含む)の形態で使用される。本発明の接着剤は、充填剤を含有させることにより、線膨張係数を所望の範囲内に調整することができ、しかも接着剤からなる膜の強度を上げ、その結果、接着強度も上げることができる。また、本発明の接着剤は、導電性充填剤を含有させることにより、異方性導電材とすることができる。さらに、本発明の接着剤は、エポキシ樹脂や石油樹脂などの低分子量成分を含有させることにより、粘度を所望の範囲に調整することができる

15

20

25

と共に、微細な凹凸を有する半導体部品や基板に対する接着性を高めることができる。本発明の接着剤は、温度サイクル試験及び高温高湿試験による評価基準を満足することができる。

本発明の接着剤は、環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする接着剤であって、硬化剤を使用しないため、リペア性に優れている。また、本発明の接着剤は、硬化剤を使用しないことから、保存安定性に優れており、また、硬化時間が不要なため、生産性に優れている。すなわち、本発明の接着剤は、加熱溶融させて接着し、その後、冷却するか、あるいは有機溶媒の溶液を塗布し、乾燥させることにより接着させることができる。

本発明によれば、(a)環状オレフィン系重合体及び(b)主鎖中に芳香環の繰り返し単位を有する芳香族縮合系重合体からなる群より選ばれる少なくとも一種の数平均分子量が1,000~500,000環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする半導体部品接着剤が提供される。

また、本発明によれば、前記接着剤を製膜してなる半導体部品接着フィルムが提供される。

本発明によれば、前記接着剤の溶液またはフィルムを用いて、半導体部品と基板とを接合させてなる半導体部品パッケージが提供される。

また、本発明によれば、基板表面に前記接着フィルムを積層し、次いで、該接着フィルムの上に半導体部品を設置した後、環構造含有熱可塑性重合体のガラス転移温度以上の温度で加熱・加圧することにより接着し、しかる後、冷却することを特徴とする半導体部品パッケージの製造方法が提供される。

さらに、本発明によれば、基板表面に前記接着剤の溶液を塗布し

25

た後、溶媒を乾燥させて接着層を形成し、次いで、該接着層の上に 半導体部品を設置した後、環構造含有熱可塑性重合体のガラス転移 温度以上の温度で加熱・加圧することにより接着し、しかる後、冷 却することを特徴とする半導体部品パッケージの製造方法が提供される。

<図面の簡単な説明>

図1は、半導体チップが組み込まれたテープキャリアパッケージ (TCP)と液晶パネルとを、異方性導電膜を介して接合・接着す 10 る方式を示す断面略図である。

<発明を実施するための最良の形態>

(半導体部品接着剤)

15 本発明で使用される半導体部品接着剤は、環状オレフィンの繰り返し単位を含む環状オレフィン系重合体及び/または主鎖中に芳香環の繰り返し単位を含有する芳香族縮合系重合体であって、数平均分子量が1,000~500,000環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする接着剤である。

20 〔環状オレフィン系重合体〕

本発明で用いる環状オレフィン系重合体は、重合体の全繰り返し単位中に、環状オレフィン系単量体由来の繰り返し単位を含有するものである。環状オレフィン系単量体としては、例えば、ノルボルネン環を有する脂環族系単量体、単環の環状オレフィン、環状共役ジエンなどが挙げられる。これらの環状オレフィン系単量体は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することがで

10

15

25

き、さらには、共重合可能な他の単量体と共重合させることができる。環状オレフィン系単量体由来の繰り返し単位は、環状オレフィン単量体の繰り返し単位だけではなく、該繰り返し単位が変性されたものをも包含する。変性としては、水素添加反応や極性基含有不飽和化合物によるグラフト変性反応などが挙げられる。

環状オレフィン系単量体の結合様式は、主鎖中に環状構造を導入 し得るものであれば特に限定されず、付加重合及び開環重合のいず れであってもよい。環状オレフィン系重合体としては、例えば、

- (1) ノルボルネン、エチリデンノルボルネン、ジシクロペンタジエン、 テトラシクロドデセンなどのノルボルネン環を有する脂環族系単量 体の炭素 - 炭素不飽和結合を付加重合した付加重合体、
 - (2) ノルボルネン環を有する脂環族系単量体と、αーオレフィンなどの不飽和単量体とを付加共重合した付加共重合体、
- (3) シクロペンテン、シクロヘキセンなどの単環の環状オレフィンの 炭素 - 炭素不飽和結合を付加重合した付加重合体、
 - (4) シクロヘキサジエンなどの環状共役ジエンを 1, 4 付加重合した付加重合体、
 - (5) ノルボルネン環を有する脂環族系単量体を開環重合させた開環重合体、及び
- 20 (6) これらの水素添加物などが挙げられる。

本発明で使用する環状オレフィン系重合体は、機械的特性、電気的特性、低吸水性が良好で、しかも耐熱性に優れていることが好ましい。これらの諸特性に優れている点で、環状オレフィン系重合体としては、熱可塑性ノルボルネン系樹脂が好ましく、特に、ノルボルネン環を有する脂環族系単量体(すなわち、ノルボルネン系モノ

10

15

20

25

マー)を主成分とする付加(共)重合体、及びノルボルネン系モノマーの開環重合体の水素添加物などの熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂が好ましい。また、耐熱性などの諸特性に優れている点で、1,3-シクロヘキサジエンなどの環状共役ジエンの1,4-付加型重合体の水素添加物も好ましい。

環状オレフィン系重合体中の環状オレフィン系単量体由来の繰返し単位の割合は、コモノマーの種類や所望の物性によって適宜定めることができるが、重合体の全繰返し単位を基準として、通常30モル%以上であることが、機械的特性、電気的特性、低吸水性、耐熱性などの観点から望ましい。例えば、ノルボルネン系モノマーとエチレンとの付加型共重合体の場合、ノルボルネン系モノマーの割合は、30モル%以上、好ましくは35モル%以上で、好ましい諸特性を有する共重合体を得ることができる。環状オレフィン系重合体中の環状オレフィン系単量体由来の繰り返し単位は、高度の耐熱性が必要とされる場合には、好ましくは50モル%以上、より好ましくは70モル%以上、最も好ましくは80モル%以上である。この上限は、100モル%である。

環状オレフィン系重合体は、示差走査熱量計(DSC)で測定したガラス転移温度(Tg)が、通常100℃以上、好ましくは110 で以上、より好ましくは120℃以上であるものが望ましい。さらに高度の耐熱性が要求される場合には、環状オレフィン系重合体のTgは、通常130℃以上、好ましくは140℃以上、より好ましくは150℃以上であることが望ましい。環状オレフィン系重合体は、高度の耐熱性が要求される場合、単量体の種類、重合方法、分子量、変性方法などを調整することにより、Tgが200℃以上とすることができる。Tgの上限は、通常、300℃程度である。環

15

20

25

状オレフィン系重合体のTgが高いことにより、該重合体を接着剤として用いて半導体部品と基板との接合を行うと、耐熱性に優れた接着層を形成することができ、半導体部品パッケージの信頼性が大幅に向上する。Tgが高すぎると、低温接着が困難となる。環状オレフィン系重合体のガラス転移温度が、上記範囲にあると、この接着剤で半導体部品パッケージを実装する際の温度範囲において、従来よりも低温接着が可能で、かつ、接着剤の耐熱性が優れて好適である。

本発明で使用する環状オレフィン系重合体の分子量は、ゲル・パー 10 ミエーション・クロマトグラフィー(GPC)により測定したポリスチレン換算の数平均分子量(Mn)で表すと、1,000~500, 000、好ましくは3,000~300,000、より好ましくは 5,000~250,000の範囲であり、多くの場合、10,000 ~200,000の範囲である。

環状オレフィン系重合体の数平均分子量が過度に小さいと、接着層の強度が低下して、クラック等が発生する原因となり、逆に数平均分子量が過度に大きいと、重合体の粘度が大きすぎて、製膜性などが悪くなり好ましくない。よって、数平均分子量が上記範囲にあると、接着層の強度と、粘度及び加工性が適度にバランスされて好ましい。

環状オレフィン系重合体は、金属配線等との接着性向上などを目的として官能基(特に、極性基)を含有するものが好ましい。環状オレフィン系重合体に官能基を含有させる方法としては、環状オレフィン系重合体を変性する方法と、官能基を有する環状オレフィン系単量体を(共)重合する方法が挙げられる。

〔環状オレフィン系単量体〕

WO 99/01519

5

10

15

20

環状オレフィン系重合体の成分を構成する環状オレフィン系単量体は、炭素一炭素不飽和結合を有する環状の炭化水素化合物であれば特に限定はされないが、主なものには、(1) ノルボルネン環を有する脂環族系単量体(ノルボルネン系モノマー)、(2) 単環の環状オレフィン系単量体、及び(3) 環状共役ジェン系単量体が挙げられる。

(1) ノルボルネン環を有する脂環族系単量体

ノルボルネン環を有する脂環族系単量体は、特開平5-320268 号公報や特開平2-36224号公報などに記載されているノルボルネン環を有する脂環族系単量体である。これらのノルボルネン環を有する脂環族系単量体は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

ノルボルネン環を有する脂環族系単量体としては、(i)ノルボルネン、テトラシクロドデセン、これらのアルキル置換体などの重合反応に関与する炭素一炭素不飽和結合以外の不飽和結合を持たない単量体、(i i)エチリデンノルボルネン、ビニルノルボルネン、エチリデンテトラシクロドデセン、ジシクロペンタジエンなどの重合反応に関与する炭素一炭素不飽和結合以外の不飽和結合を持つ単量体、(i i i)ジメタノテトラヒドロフルオレン、フェニルノルボルネンなどの芳香環を持つ単量体、(i v)メトキシカルボニルノルボルネン、メトキシカルボニルテトラシクロドデセンなどの極性基を有する単量体などを挙げることができる。より詳細には、以下の通りである。

(i) 重合反応に関与する炭素-炭素不飽和結合以外に不飽和結
 25 合を持たない単量体の具体例としては、例えば、ビシクロ [2.2.2.1] ヘプトー2-エン、5-メチルビシクロ [2.2.1] ヘプト

-2-エン、5-エチルビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン、 5-ブチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヘキシ ルビシクロ「2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-デシルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、などのビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン誘導体(ノルボルネン類);テトラシクロ[4. 5 ルテトラシクロ $[4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0]$ -ドデカー3ーエン などのテトラシクロ $[4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0]$ - ドデカー 3 -エン誘導体(テトラシクロドデセン類);トリシクロ「4.3.1², 10 5. 0] ーデカー3ーエン:5ーシクロヘキシルビシクロ「2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-シクロペンチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エンなどの環状置換基を有するビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン誘導体、などが挙げられる。

結合を持つ単量体の具体例としては、例えば 5 - エチリデンビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5 - ビニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5 - プロペニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、などの環外に不飽和結合を持つビシクロ [2.2.2.1] ヘプト-2-エン、などの環外に不飽和結合を持つビシクロ [2.2.2.2.20 1] ヘプト-2-エン誘導体; 8 - メチリデンテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] - ドデカ-3-エン、8-エチリデンテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] - ドデカ-3-エン、8-ビニルテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] - ドデカ-3-エン、8-プロペニルテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] - ドデカ-3-エン、などの環外に不飽和結合を持つテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0]

(ii) 重合反応に関与する炭素 - 炭素不飽和結合以外に不飽和

10

クロ [4.3.1^{2,5}.0] - デカー3,7 - ジェン;5 - シクロヘキセニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2 - エン、5 - シクロペンテニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2 - エンなどの不飽和結合を持つ環状置換基を有するビシクロ [2.2.1] ヘプト-2 - エン誘導体、などが挙げられる。

(iii)芳香環を有する単量体の具体例としては、例えば、5 -7ェニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、テトラシクロ [6.5.1 2,5 .0 1,6 .0 8,13] トリデカ-3,8,10,12 - テトラエン(1,4- メタノ-1,4,4a,9a- テトラヒドロフルオレンともいう)、テトラシクロ [6.6.1 2,5 .0 1,6 .0 8,13] テトラデカ-3,8,10,12- テトラエン(1,4- メタノ-1,4,4a,5,10,10a- ヘキサヒドロアントラセンともいう)、などが挙げられる。

(iv)極性基(官能基)を有する単量体の具体例としては、例 15 えば、5-メトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2 ーエン、5 - エトキシカルボニルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-xン、5-xチルー5-xトキシカルボニルビシクロ[2.2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーエトキシカルボニルビシ クロ[2. 2. 1] ヘプト-2-エン、ビシクロ[2. 2. 1] ヘ 20 プト-5-エニル-2-メチルプロピオネイト、ビシクロ「2.2. 1] ヘプト-5-エニル-2-メチルオクタネイト、ビシクロ「2. 2.1] ヘプト-2-エン-5, 6-ジカルボン酸無水物、5-ヒ ドロキシメチルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5,6 ージ(ヒドロキシメチル)ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエ ン、5-ヒドロキシーi-プロピルビシクロ[2.2.1] ヘプト 25 -2 - エン、 5 , 6 - ジカルボキシビシクロ [2 . 2 . 1] ヘプト

- 2 - エン、などの酸素原子を含む置換基を有するビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン誘導体;8-メトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] ードデカ-3-エン、8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] ードデカ-3-エン、8-ヒドロキシメチルテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] ードデカ-3-エン、8-カルボキシテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] ードデカ-3-エン、などの酸素原子を含む置換基を有するテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] ードデカ-3-エン、などの酸素原子を含む置換基を有するテトラシクロ [4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0] ードデカ-3-エン誘導体;5-シアノビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン-5,6-ジカルボン酸イミドなどの窒素原子を含む置換基を有するビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン誘導体、などが挙げられる。

なお、上記全てのノルボルネン環を有する脂環族系単量体に共通 して、さらに炭素数 4 個以上のアルキル置換基を持つノルボルネン 環を有する脂環族系単量体が挙げられる。または、これらの単量体 は、それぞれ単独で、あるいは 2 種以上を組み合わせて使用するこ とができる。

(2) 単環の環状オレフィン系単量体

20 単環の環状オレフィン系単量体は、炭素-炭素二重結合を環内に一つ有する環状化合物である。その具体例としては、シクロブテン、シクロペンテン、シクロペキセン、シクロペプテン、シクロオクテンなどを挙げることができる(特開昭64-66216号公報)。これらの単環の環状オレフィン系単量体は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

25

(3)環状共役ジエン系単量体

環状共役ジェン系単量体は、環内に共役系炭素-炭素二重結合を有する環状化合物である。その具体例としては、1、3-シクロペンタジェン、1、3-シクロペキサジェン、1、3-シクロペプタジェン、1、3-シクロオクタジェンなどを挙げることができる(特開平7-258318号公報)。これらの環状共役ジェン系単量体は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

環状オレフィン系単量体と共重合可能な不飽和単量体としては、
10 エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテンな
どの炭素数2~12からなるα-オレフィン類;スチレン、α-メ
チルスチレン、p-メチルスチレン、p-クロロスチレンなどのス
チレン類;1,3-ブタジエン、イソプレンなどの鎖状共役ジエン;
エチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテルなどのビニルエー
うたい類や一酸化炭素を挙げることができる。このような不飽和単量
体としては、環状オレフィン系単量体と共重合が可能であるならば、
特に上記のものに限定されるものではない。ノルボルネン環を有す
る脂環族系単量体とその他の不飽和単量体とを付加共重合させる場合には、その他の不飽和単量体として、前記のα-オレフィン類な
20 どのビニル化合物が好ましく、特にエチレンが好ましい。

〔芳香族縮合系重合体〕

本発明における芳香族縮合系重合体は、主鎖中に芳香環の繰り返し単位を有し、芳香環同士がヘテロ原子を含む単位構造で結合したものである。ヘテロ原子としては、特に限定されないが、例えば、酸素や硫黄が挙げられ、結合形態としては、例えば、エーテル結合やエステル結合がある。芳香族縮合系重合体の具体例としては、例

10

15

20

25

えば、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンエーテル、ポリエーテルスルホン、ポリスルフォンなどの芳香族ポリエーテル系重合体;液晶プラスチック、芳香族ポリエステル、ポリアリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエーテルケトン、ポリエーテルケトンなどの芳香族ポリエステル:などが挙げられる。

これらの中でも、耐熱性、低吸湿性、誘電特性などの点で、芳香環とヘテロ原子の単純なエーテル結合から構成されるポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンエーテルなどの芳香族ポリエーテル系重合体が好ましく、芳香族ポリエステル系重合体のなかでも、単位構造に対する芳香環の含有量が多い液晶プラスチックのようなものが好ましい。特に、上記3種類の重合体が好ましいが、諸特性の点で、ポリフェニレンエーテル(PPE)が最も好ましい。

芳香族縮合系重合体の分子量は、GPCにより測定したポリスチレン換算の数平均分子量(Mn)で表すと、1,000~500,000、好ましくは3,000~300,000、より好ましくは5,000~250,000である。なお、GPCにより数平均分子量が測定できない芳香族縮合系重合体の場合には、溶融粘度などを分子量の指標として使用することができる。

芳香族縮合系重合体のTgは、DSC測定にて、100~300 ℃、120~250℃、より好ましくは140~200℃である。 芳香族縮合系重合体のガラス転移温度が、上記範囲にあると、この 接着剤で半導体部品パッケージを実装する際の温度範囲において、 従来よりも低温接着が可能で、かつ、接着剤の耐熱性が優れて好適 である。

〔官能基を含有する環構造含有熱可塑性重合体〕

本発明で使用する環構造含有熱可塑性重合体は、金属との接着性を向上させたり、他の配合剤、樹脂等との相溶性を向上させたり、耐熱性を向上させる等の目的で、官能基(特に、極性基)を含有していることが好ましい。

本発明で使用する官能基含有環状オレフィン系重合体の極性基とは、金属(特に半導体チップ及び電極)や配線基板(絶縁樹脂、金属配線、電極)との接着性を向上させ得る官能基であれば特に限定されず、例えば、エポキシ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、ハロゲン基、シラノール基、シリル基、アミノ基、ニトリル基、ハロゲン基、アシル基、スルホン基などが挙げられる。これらの官能基の中でも、少ない変性率で接着性の向上が可能であるなどの理由から、例えば、エポキシ基、酸無水物基、酸無水物の開環物基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、シラノール基などの極性基が好ましい。

官能基を含有する環構造含有熱可塑性重合体は、環構造含有熱可塑性重合体に、例えば、下記の3種類の方法によって、官能基を導入して得ることができる。

- (1) 重合体に、官能基含有不飽和化合物をグラフト反応によって付 20 加させる方法、
 - (2) 重合体中の炭素 炭素不飽和結合に直接官能基を導入する方法、
 - (3) 重合体の重合の際に、官能基を含有する単量体を共重合させる 方法。

以下に、それぞれの官能基の導入方法の詳細を説明する。

25 (1)官能基含有不飽和化合物のグラフト反応

官能基を含有する環構造含有熱可塑性重合体は、環構造含有熱可

塑性重合体を、有機過酸化物の存在下に、官能基含有不飽和化合物 と反応させることにより得ることができる。官能基含有不飽和化合 物としては、特に限定されないが、少量で接着性が向上するので、 エポキシ基含有不飽和化合物、カルボキシル基含有不飽和化合物、 ヒドロキシル基含有不飽和化合物、シリル基含有不飽和化合物など が好ましい。

エポキシ基含有不飽和化合物としては、例えば、グリシジルアク リレート、グリシジルメタクリレート、p-スチリルカルボン酸グ リシジル等の不飽和カルボン酸のグリシジルエステル類:エンド-シスービシクロ[2, 2, 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカル 10 ボン酸、エンドーシスービシクロ[2,2,1] ヘプトー5ーエン - 2 - メチル- 2, 3 - ジカルボン酸等の不飽和ポリカルボン酸の モノグリシジルエステルあるいはポリグリシジルエステル類;アリ ルグリシジルエーテル、2 - メチルアリルグリシジルエーテル、ο ーアリルフェノールのグリシジルエーテル、m-アリルフェノール 15 のグリシジルエーテル、p-アリルフェノールのグリシジルエーテ ル等の不飽和グリシジルエーテル類;2-(o-ビニルフェニル) エチレンオキシド、2-(p-ビニルフェニル) エチレンオキシド、 2- (o-アリルフェニル) エチレンオキシド、2- (p-アリル 20 フェニル) エチレンオキシド、2 - (o‐ビニルフェニル) プロピ レンオキシド、2- (p-ビニルフェニル) プロピレンオキシド、 2-(o-アリルフェニル)プロピレンオキシド、2-(p-アリ ルフェニル) プロピレンオキシド、p - グリシジルスチレン、3, 4-エポキシー1-ブテン、3,4-エポキシー3-メチルー1-25 プテン、3, 4-エポキシー1-ペンテン、3, 4-エポキシー3 ーメチル-1-ペンテン、5,6-エポキシ-1-ヘキセン、ビニ

10

15

20

25

ルシクロヘキセンモノオキシド、アリルー2,3ーエポキシシクロペンチルエーテルなどが挙げられる。これらの中でも、特に高い反応率で該エポキシ基含有不飽和化合物がグラフト付加できるという点で、アリルグリシジルエステル類及びアリルグリシジルエーテル類が好ましく、アリルグリシジルエーテル類が特に好ましい。これらのエポキシ基含有不飽和化合物は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

カルボキシル基含有不飽和化合物としては、特開平5-271356 号公報に記載の化合物などが挙げられ、例えば、アクリル酸、メタ クリル酸、α-エチルアクリル酸等の不飽和カルボン酸;マレイン 酸、フマール酸、イタコン酸、エンドシスービシクロ [2.2.1] ヘプトー5-エンー2,3-ジカルボン酸、メチルーエンドシスー ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボン酸 等の不飽和ジカルボン酸などが挙げられる。また、カルボキシ基含 有不飽和化合物には、不飽和カルボン酸誘導体も含まれる。不飽和 カルボン酸誘導体としては、例えば、不飽和カルボン酸の酸無水物、 エステル、酸ハライド、アミド、イミドなどが挙げられ、具体的に は、無水マレイン酸、クロロ無水マレイン酸、ブテニル無水コハク 酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水シトラコン酸などの酸無水物; マレイン酸モノメチル、マレイン酸ジメチル、グリシジルマレエー トなどのエステル;塩化マレニル、マレイミドなどが挙げられる。 これらの中では、不飽和ジカルボン酸またはその酸無水物が好まし く、中でも無水マレイン酸やイタコン酸などの酸無水物が特に好ま しい。

ヒドロキシル基含有不飽和化合物としては、例えば、アリルアル コール、2-アリル-6-メトキシフェノール、4-アリロキシ-2

25

ーヒドロキシベンゾフェノン、3-アリロキシ-1,2-プロパン ジオール、2-アリルジフェノール、3-プテン-1-オール、4 - ペンテン-1-オール、5-ヘキセン-1-オールなどが挙げら れる。

シリル基含有不飽和化合物としては、例えば、クロロジメチルビ 5 ニルシラン、トリメチルシリルアセチレン、5-トリメチルシリル -1, 3-シクロペンタジエン、3-トリメチルシリルアリルアル コール、トリメチルシリルメタクリレート、1-トリメチルシリロ キシー1, 3-ブタジエン、1-トリメチルシリロキシーシクロペ ンテン、2-トリメチルシリロキシエチルメタクリレート、2-ト 10 リメチルシリロキシフラン、2-トリメチルシリロキシプロペン、 アリロキシーt-ブチルジメチルシラン、アリロキシトリメチルシ ランなどが挙げられる。

有機ケイ素不飽和化合物としては、トリメトキシビニルシラン、 トリエトキシビニルシラン、トリス (メトキシエトキシ) ビニルシ ランなどのトリスアルコキシビニルシランが好ましい。このような 有機ケイ素不飽和化合物のアルコキシ基は、加水分解を受けてシラ ノール基を形成することができる。

有機過酸化物としては、特に限定されず、従来より不飽和化合物 20 のグラフト反応に用いられているようなものであれば使用可能であ る。有機過酸化物の具体例としては、有機ペルオキシド、有機ペル エステルなどが好ましく使用される。このような有機過酸化物の具 体例としては、ベンゾイルペルオキシド、ジクロロベンゾイルペル オキシド、ジクミルペルオキシド、ジーtert-ブチルペルオキ シド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(ペルオキシドベンゾエート) ヘキシン-3,1,4-ビス(tert-ブチルペルオキシイソプ

10

15

ロピル)ベンゼン、ラウロイルペルオキシド、tert-ブチルペルアセテート、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ (tert-ブチルペルオキシ) へキシン-3, 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ (tert-ブチルペルオキシ) へキサン、<math>tert-ブチルペルベンゾエート、 tert-ブチルベルフェニルアセテート、 <math>tert-ブチルベルフェニルアセテート、 tert-ブチルベルイソブチレート、 tert-ブチルペル-sec-オクトエート、 tert-ブチルペルピパレート、クミルペルピパレート、及び <math>tert-ブチルペルジエチルアセテートを挙げることができる。</code>

さらに、本発明においては、有機過酸化物としてアゾ化合物を使用することもできる。アゾ化合物の具体例としては、アゾビスイソブチロニトリル及びジメチルアゾイソブチレートを挙げることができる。

これらの中でも、有機過酸化物として、ベンゾイルペルオキシド、ジクミルペルオキシド、ジーtertーブチルペルオキシド、2,5-ジメチルー2,5-ジ(tertーブチルペルオキシド)へキシン-3,2,5-ジメチルー2,5-ジ(tertーブチルペルオキシ)へキサン、1,4-ビス(tertーブチルペルオキシイソプロピル)ベンゼン等のジアルキルペルオキシドが好ましく用いられる。

20 これらの有機過酸化物は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。有機過酸化物の使用割合は、反応時の仕込み割合で未変性の環構造含有熱可塑性重合体100重量部に対して、通常0.001~30重量部、好ましくは0.01~20重量部、より好ましくは0.1~10重量部の範囲である。有機過酸化物の使用量がこの範囲にあるとき、官能基含有不飽和化合物の反応率、得られた変性重合体の吸水率、誘電特性などの諸物性

15

が高度にバランスされ好適である。

グラフト変性反応は、特に限定はなく、常法に従って行うことができる。反応温度は、通常 0 ~ 4 0 0 ℃、好ましくは 6 0 ~ 3 5 0 ℃である。反応時間は、通常 1 分~ 2 4 時間、好ましくは 3 0 分~ 1 0 時間の範囲である。反応終了後は、メタノール等の貧溶媒を多量に反応系に添加してポリマーを析出させ、濾別洗浄後、減圧乾燥等により得ることができる。

(2) 炭素 - 炭素不飽和結合の直接変性

官能基を含有する環構造含有熱可塑性重合体は、環構造含有熱可 塑性重合体中にオレフィン性炭素-炭素不飽和結合を有するものの 場合には、該不飽和結合を変性して官能基を付加したり、該不飽和 結合に官能基を有する化合物を結合させたりして、官能基を導入す ることができる。

官能基の導入方法に関しては、特開平6-172423号公報に 記載されているような方法を用いることができる。具体的には、オ レフィン性不飽和結合の酸化による方法、分子内に1つ以上の官能 基を含有する化合物のオレフィン性不飽和結合への付加反応による 方法、及びその他の方法によって、エポキシ基やカルボキシル基、 ヒドロキシル基等の官能基を導入する方法が挙げられる。

20 (3) 官能基含有単量体の共重合

本発明で使用する官能基含有単量体としては、特に限定されないが、前述の単量体の説明の中の(i v)の極性基を有する単量体を挙げることができる。これらの中でも、共重合のしやすいものとして、5-ヒドロキシメチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2-エン、5-ヒドロキシーi-プロピルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2-エース・5-メトキシカルボニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2-エン、5-メトキシカルボニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプ

10

トー2ーエン、8ーメトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}.]ードデカー3ーエン、5,6ージカルボキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、などのヒドロキシ基、カルボキシル基またはエステル基を含有する単量体が好ましい。重合触媒及び重合方法は、ノルボルネン系単量体の重合触媒及び重合方法を用いることができる。

以上の中でも、官能基の導入方法としては、容易な反応条件で変性を実施することができ、高い変性率で極性基を導入することが容易である等の理由により、グラフト変性法が好ましく、グラフト反応する官能基含有不飽和化合物の種類としては、前述の理由によりエポキシ基、無水マレイン酸、及び無水イタコン酸等の分子内に炭素一炭素不飽和結合を有するジカルボン酸無水物基を持った不飽和化合物が特に好ましい。

(4)官能基導入率

15 官能基を含有する環構造含有熱可塑性重合体の官能基導入率(変性率)は、使用目的に応じて適宜選択されるが、重合体中の総モノマー単位数を基準として、通常 0.1~100 モル%、好ましくは0.5~70 モル%、より好ましくは1~50 モル%の範囲である。官能基の導入率がこの範囲にあるとき、金属との接着強度、耐熱性、20 機械的強度、吸水率、誘電特性が高度にバランスされ、好適である。官能基としては、前述のとおり、極性基が好ましい。

官能基導入率(変性率:モル%)は、下式(1)で表される。

官能基導入率 = $(X/Y) \times 100$ (1)

- X:(a)グラフトモノマー変性残基全モル数、あるいは
- 25 (b)不飽和結合含有モノマーの全モル数×不飽和結合への 官能基付加率、あるいは

(c) 官能基含有モノマーの全モル数。(いずれも¹H - NMRで測定する。)

Y:ポリマーの総モノマー単位数(ポリマーの.重量平均分子量/ モノマーの平均分子量)

5

15

20

(接着性樹脂組成物)

本発明の接着剤は、上記環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする接着剤であり、充填剤を含有する樹脂組成物であることが望ましい。

10 〔充填剤〕

充填剤は、主に、(1)接着剤の線膨張係数と半導体部品及び基板の線膨張係数の値を近づけて剪断応力を低減させる、(2)半導体部品の電極バンプと基板の電極を導通させる、(3)半導体素子や基板と接着剤の接着強度(凝集破壊強度)を向上させる、といった目的で配合される。

充填剤の種類は、上記要求を満たすものであれば特に限定されないが、具体的には例えば、(1)及び(3)の目的では、従来から半導体部品の樹脂封止材料に使用されてきた各種充填剤を用いることができる。それらの中でも、線膨張係数の小さい充填剤として無機フィラーが好ましく、線膨張係数が特に小さい溶融シリカ(非晶質シリカ、石英ガラスと同義)がより好ましい。前記(2)の目的では、従来、異方性導電膜に使用されてきた導電性粒子(導電性フィラー)が挙げられる。

(1) 充填剤(非導電性充填剤、特に無機フィラー)

25 非導電性の充填剤は、特に限定されず、例えば、従来よりエポキシ樹脂接着剤や封止材に用いられているものを使用することができ

10

15

20

25

る。充填剤の具体例としては、例えば、シリカ、ケイ藻土、アルミナ、酸化チタン、酸化マグネシウム、軽石粉、軽石バルーン、塩基性炭酸マグネシウム、ドロマイト、硫酸カルシウム、チタン酸カリウム、硫酸バリウム、亜硫酸カルシウム、タルク、クレー、マイカ、アスベスト、ガラス繊維、ガラスフレーク、ガラスビーズ、ケイ酸カルシウム、モンモリロナイト、ベントナイト、グラファイト、アルミニウム粉、硫化モリブデン、ボロン繊維、炭化ケイ素繊維、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維などが挙げられる。これら充填剤の中でも、特に、耐熱性、低吸水率、誘電特性、低不純物性等に優れる理由から、無機フィラーが好ましく、特にシリカが好ましい。

非導電性の充填剤(特に、無機フィラー)は、環構造含有熱可塑性重合体100重量部に対して、通常1~100重量部、好ましくは5~70重量部、より好ましくは10~50重量部の割合で使用する。充填剤を配合することにより、接着剤の線膨張係数を所望の範囲に調整することができると共に、接着剤層の強度(膜強度)を上げる作用効果があり、それによって、接着強度も向上する。充填剤の配合割合が過小であると、添加効果が小さく、逆に、過大であると、接着力が低下する。ただし、高度の接着強度が要求されない用途の場合には、前記範囲よりも多量の充填剤を含有させることも可能であり、それによって、熱伝導性などを向上させることもできる。

(2) 導電性粒子(導電性フィラー)

導電粒子の種類については、特に限定されず、基材高分子及び被 着体の種類により適宜選択される。具体例としては「工業調査会: エレクトロニクス実装技術基礎講座、第4巻、実装組立技術、第6

10

15

20

25

章」に記載の導電性フィラーなどが挙げられる。

導電性粒子としては、例えば、①ニッケル、アルミニウム、銀、銅、錫、鉛、金、亜鉛、白金、コバルト、及びこれらの合金(例えば、ハンダ)などの金属粒子、②凝集金属粒子、③溶融金属粒子、④導電性カーボンブラックやカーボン単繊維などの導電性カーボン系粒子、⑤スチレン系、フェノール系、エポキシ系樹脂粒子あるいはこれらの樹脂粒子とハンダなどの複合粒子にNi、Auなどの金属メッキ処理をした金属被覆樹脂粒子、⑥ポリウレタン系樹脂などの柔軟性のある樹脂に金属粒子を分散させて複合化した複合樹脂粒子、及び⑦マイクロカプセル型導電性粒子などが挙げられる。

マイクロカプセル型導電性粒子は、導電性粒子の表面に絶縁性樹 脂層が形成されたものであり、例えば、(i)ニッケル、アルミニウム、 銀、銅、錫、鉛、金、亜鉛、白金、コバルト、及びこれらの合金(例 えば、はんだ)などの金属粒子の表面に絶縁性樹脂を被覆したもの、 (ii)樹脂粒子にNi、Auなどの金属メッキ処理をした金属被覆樹脂 粒子の表面に絶縁性樹脂を被覆したもの、(iii) 樹脂と金属粒子とを 複合化した複合樹脂粒子の表面に絶縁性樹脂を被覆したものなどを 挙けることができる。絶縁性樹脂としては、熱可塑性樹脂と熱硬化 性樹脂とがある。マイクロカプセル型導電性フィラーの製造方法と しては、特に限定されず、公知の方法を採用することができる。具 体的には、球形の芯物質樹脂上に導電性の中間層を設け、その上に 絶縁性熱可塑性樹脂をコーティングする方法や、球形の導電性微粒 子表面に絶縁性熱可塑性樹脂をコーティングする方法、プラズマ重 合またはプラズマCVD重合により、導電性粒子表面に熱可塑性樹 脂または熱硬化性樹脂の絶縁膜を形成する方法、モノマーを導電性 微粒子表面で<u>in situ</u>重合させてポリマー化し、コーティン

グする方法などが挙げられる。絶縁性樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、スチレン樹脂、アクリル/スチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂などの熱可塑性樹脂;エポキシ/アミン系の硬化物、マレイミド/アミン系の硬化物、ジビニルベンゼン重合体などの熱硬化性樹脂などがある。これらの絶縁性樹脂は、チップと基板の熱圧着温度に耐え得る耐熱性を有するものが好ましい。絶縁性樹脂からなる被覆層の厚みは、3μm以下であることが好ましい。絶縁性樹脂層の膜厚の下限は、製造法にもよるが、通常、0.05μm程度である。

10 導電性粒子の形状は、特に限定されはないが、球状、粒状、または扁平状であることが、加熱加圧により端子間で面接触効果を充分に得る上で好ましい。本発明で使用される導電性フィラーの平均粒径は、使用目的に応じて適宜選択されればよく、(長径+短径)/2の平均粒径で、通常 0. 1~30 μm、好ましくは 1~20 μm、15 より好ましくは 5~15 μmの範囲である。

これらの導電性粒子は、基材高分子の環構造含有熱可塑性重合体に均一に分散しやすいもの、半導体部品の電極や基板の電極の材料と密着性に優れるものが好ましい。

これらの導電性粒子は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組 20 み合せて用いることができる。導電性粒子の配合割合は、使用目的 に応じて適宜選択されるが、環構造含有熱可塑性重合体100重量 部に対して、通常1~100重量部、好ましくは2~70重量部、 より好ましくは3~50重量部の範囲であるときに、誘電特性、接 着性、及び長期信頼性が高度にバランスされて好適である。導電性 粒子の配合割合は、多くの場合5~30重量部である。導電性粒子 の配合割合が過小であると、端子間接合が不充分となり、特に微細

10

15

20

ピッチ化に対応することが困難となる。導電性粒子の配合割合が過大であると、接着力が低下したり、横方向の絶縁性が損なわれるおそれが生じる。

電子部品の小型化や高密度実装が進みにつれて、端子間隔が縮小してきており、電極の微細ピッチ化への対応と接続部の高信頼性の確保が求められている。ところが、従来の異方性導電材では、微細ピッチ化への対応を充分に行うことができない。微細ピッチ化の進展により、例えば、ビームリードタイプの半導体チップの場合、ビームリードの幅は50~100μmで、リード間隔も50~100μm程度となっている。このような微細ピッチ化した電子部品に対し、従来の異方性導電材を用いてバンプ接合する場合、バンプ相互間の絶縁性を確保することが困難である。これに対して、本発明の接着剤は、基材高分子の誘電特性に優れているため、これらの要求に応えることができる。また、導電性粒子として、マイクロカプセル型導電性粒子などを使用することにより、導電性粒子の高充填が可能となり、これによっても、電極の微細ピッチ化へ対応することができるようになる。

図1に、異方性導電膜を用いた半導体部品と基板との接合の機構に関する説明図を示す。樹脂(接着剤)1中にマイクロカプセル型導電性フィラー2を分散した異方性導電材料を用いて、TCP3のリード4上から異方性導電膜を形成する。これを液晶パネル6の電極6側と加熱・圧着すると、両電極間に存在するマイクロカプセル型導電性フィラー2が潰されて、両電極間を導通させる。

20

25

[配合剤]

本発明の接着剤には、以下に記載するような配合剤が配合されて いてもよい。

(1)難燃剤

難燃剤は、必須成分ではないが、特にCPUやDRAMなどのLSI チップを接着する場合には、添加するのが好ましい。難燃剤として は、特に制約はないが、硬化剤によって、分解、変性、変質しない ものが好ましく、通常ハロゲン系難燃剤が用いられる。

ハロゲン系難燃剤としては、塩素系及び臭素系の種々の難燃剤が 使用可能であるが、難燃化効果、成形時の耐熱性、樹脂への分散性、 10 樹脂の物性への影響等の面から、ヘキサブロモベンゼン、ペンタブ ロモエチルベンゼン、ヘキサブロモビフェニル、デカブロモジフェ ニル、ヘキサブロモジフェニルオキサイド、オクタブロモジフェニ ルオキサイド、デカプロモジフェニルオキサイド、ペンタブロモシ クロヘキサン、テトラプロモビスフェノールA、及びその誘導体 [例 15 えば、テトラブロモビスフェノールA-ビス (ヒドロキシエチルエー テル)、テトラブロモビスフェノールA-ビス(2.3-ジブロモ プロピルエーテル)、テトラプロモビスフェノールA-ビス (ブロ モエチルエーテル)、テトラブロモビスフェノールA-ビス(アリ ルエーテル) 等]、テトラプロモビスフェノールS、及びその誘導 体[例えば、テトラブロモビスフェノールS-ビス(ヒドロキシエ チルエーテル)、テトラプロモビスフェノールS-ビス (2, 3-ジプロモプロピルエーテル)等〕、テトラブロモ無水フタル酸、及 びその誘導体[例えば、テトラブロモフタルイミド、エチレンビス テトラプロモフタルイミド等]、エチレンビス(5, 6-ジプロモ ノルボルネン-2. 3 - ジカルボキシイミド)、トリス- (2, 3)

10

20

ージブロモプロピルー1)ーイソシアヌレート、ヘキサクロロシクロペンタジエンのディールス・アルダー反応の付加物、トリブロモフェニルグリシジルエーテル、トリブロモフェニルアクリレート、エチレンビストリブロモフェニルエーテル、エチレンビスペンタブロモフェニルエーテル、テトラデカブロモジフェノキシベンゼン、臭素化ポリスチレン、臭素化ポリフェニレンオキサイド、臭素化ポポート、ポリペンタブロモベンジルアクリレート、オクタブロモナフタレン、ヘキサブロモシクロドデカン、ビス(トリブロモフェニル)フマルアミド、N-メチルヘキサプロモジフェニルアミン等を使用するのが好ましい。

難燃剤の添加量は、環構造含有熱可塑性重合体100重量部に対して、通常3~150重量部、好ましくは10~140重量部、特に好ましくは15~120重量部である。

難燃剤の難燃化効果をより有効に発揮させるための難燃助剤として、例えば、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、アンチモン酸ナトリウム、三塩化アンチモン等のアンチモン系難燃助剤を用いることができる。これらの難燃助剤は、難燃剤100重量部に対して、通常1~30重量部、好ましくは2~20重量部の割合で使用する。

これらの難燃剤は、特に基材高分子のガラス転移温度(Tg)が高い場合には、同時に、可塑剤としての役割を果たさせるために添加することもできる。例えば、Tgが300℃の基材高分子100 重量部に、リン系難燃剤を15重量部程度添加して、Tgを200 ℃程度に低下させることができる。

(2)低分子量樹脂

25 本発明においては、例えば、接着剤の基材高分子(すなわち、環構造含有熱可塑性重合体)の加熱溶融時の粘度特性の向上を目的と

10

20

25

して、低分子量樹脂を配合することができる。このような低分子量 樹脂を配合することにより、接着剤の粘度特性を向上することに加 えて、半導体部品や配線基板などの微細な凹凸面に対する接着性が 良好となる。また、このような低分子量樹脂を配合することにより、 温度サイクル試験及び高温高湿試験による評価基準を満足させるこ とができる。

低分子量樹脂としては、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂(ポリアミド酸)、ビスマレイミド・トリアジン樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂などの熱硬化性樹脂;石油樹脂などを挙げることができる。これらの中でも、エポキシ樹脂が好ましい。ただし、本発明では、これらの熱硬化性樹脂は、硬化させることなく使用する。

低分子量樹脂は、環構造含有熱可塑性重合体 1 0 0 重量部に対して、通常 1 ~ 5 0 重量部、好ましくは 3 ~ 4 0 重量部、より好ましくは 5 ~ 3 0 重量部の割合で使用する。

15 (3) その他の重合体成分

本発明においては、接着剤中に、必要に応じて、ゴム質重合体やその他の熱可塑性樹脂を配合することができる。

ゴム質重合体は、常温(25 $^{\circ}$)以下のガラス転移温度を持つ重合体であって、通常のゴム状重合体及び熱可塑性エラストマーが含まれる。ゴム質重合体のムーニー粘度($^{\circ}$ ML $_{1+4}$,100 $^{\circ}$)は、使用目的に応じて適宜選択され、通常5~200である。

ゴム状重合体としては、例えば、エチレンーαーオレフィン系ゴム質重合体;エチレンーαーオレフィンーポリエン共重合体ゴム;エチレンーメチルメタクリレート、エテレンーブチルアクリレートなどのエチレンと不飽和カルボン酸エステルとの共重合体;エチレンー酢酸ビニルなどのエチレンと脂肪酸ビニルとの共重合体;アク

10

15

20

リル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸ラウリルなどのアクリル酸アルキルエステルの重合体;ポリブタジエン、ポリソブレン、スチレンーブタジエンまたはスチレンーイソプレンのランダム共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、ブタジエンー(メタ)アクリル酸アルキルエステル共重合体、ブタジエンー(メタ)アクリル酸アルキルエステルーアクリロニトリル共重合体、ブタジエンー(メタ)アクリル酸アルキルエステルーアクリロニトリル共重合体、ブタジエンー(メタ)アクリル酸アルキルエステルーアクリロニトリル共重合体などのジエン系ゴム;ブチレンーイソプレン共重合体などが挙げられる。

熱可塑性エラストマーとしては、例えば、スチレンーブタジエンプロック共重合体、水素化スチレンープタジエンプロック共重合体、スチレンーイソプレンブロック共重合体、水素化スチレンーイソプレンブロック共重合体、水素化スチレンーイソプレンブロック共重合体、水素では、エチレンープロピレンエラストマー、熱可塑性ポリエステルエラストマー、エチレン系アイオノマー樹脂などを挙げることができる。これらの熱可塑性エラストマーの中でも、水素化スチレンーブタジエンブロック共重合体、水素化スチレンープタジエンブロック共重合体、水素化スチレンーイソプレンプロック共重合体などが好ましく、より具体的には、特開平2-133406号公報、特開平2-305814号公報、特開平3-72512号公報、特開平3-74409号公報などに記載されているものを挙げることができる。

その他の熱可塑性樹脂としては、例えば、低密度ポリエチレン、 25 高密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、超低密度ポリエ チレン、エチレン-エチルアクリレート共重合体、エチレン-酢酸

ビニル共重合体、ポリスチレン、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンエーテル、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、セルローストリアセテートなどが挙げられる。

これらのゴム状重合体やその他の熱可塑性樹脂は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができ、その配合量は、本発明の目的を損なわない範囲で適宜選択されるが、接着材料の特性を損なわせないためには、環構造含有熱可塑性重合体100重量部に対して、30重量部以下であるのが好ましい。

(4) その他の配合剤

10 本発明の接着剤には、必要に応じて、耐熱安定剤、耐候安定剤、 レベリング剤、帯電防止剤、スリップ剤、アンチブロッキング剤、 防曇剤、滑剤、染料、顔料、天然油、合成油、ワックスなどのその 他の配合剤を適量添加することができる。

具体的には、例えば、テトラキス[メチレン-3(3,5-ジー t - ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート] メタン、 15 β - (3, 5 - ジー t - ブチルー 4 - ヒドロキシフェニル) プロピ オン酸アルキルエステル、2, 2′-オキザミドビス [エチル-3 (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネー ト]などのフェノール系酸化防止剤;トリスノニルフェニルホスフ ァイト、トリス (2, 4 - ジー t - ブリルフェニル) ホスファイト、 20 トリス (2, 4-ジー t - ブチルフェニル) ホスファイト等のリン 系安定剤;ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、12-ヒ ドロキシステアリン酸カルシウム等の脂肪酸金属塩;グリセリンモ ノステアレート、グリセリンモノラウレート、グリセリンジステア レート、ペンタエリスリトールモノステアレート、ペンタエリスリ 25 トールジステアレート、ペンタエリスリトールトリステアレート等

25

の多価アルコール脂肪酸エステル;合成ハイドロタルサイト;アミン系の帯電防止剤;フッ素系ノニオン界面活性剤、特殊アクリル樹脂系レベリング剤、シリコーン系レベリング剤など塗料用レベリング剤;シランカップリング剤、チタネートカップリング剤、アルミニウム系カップリング剤、ジルコアルミネートカップリング剤等のカップリング剤;可塑剤;カーボンブラックなどの顔料や染料などの着色剤;などを挙げることができる。

(接着剤の形態)

10 半導体部品接着剤は、前記の環構造含有熱可塑性重合体を基材高 分子として含有する接着剤であり、該基材高分子の他に充填剤(無 機フィラーや導電性フィラー)、低分子量樹脂などの各種配合剤を 含有することができる。

本発明の接着剤のひとつの形態は、これらの成分が有機溶媒中に 均一に溶解ないしは分散した接着剤溶液である。溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素; n - ペンタン、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素;シクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;クロロベンゼン、ジクロルベンゼン、トリクロルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素;などを挙げる ことができる。

溶媒は、環構造含有熱可塑性重合体及び必要に応じて配合する各成分を均一に溶解ないしは分散するに足りる量比で用いられるが、通常は、固形分濃度が1~80重量%であり、好ましくは5~60重量%、より好ましくは10~50重量%である。

本発明の接着剤の他の形態は、接着フィルム(シートを含む)である。半導体部品接着フィルムは、環構造含有熱可塑性重合体及び

10

20

必要に応じて配合する各成分を含む接着剤(組成物を含む)をキャスティング法、溶融押出法等を用いて製膜することにより製造することができる。より具体的には、接着剤を平滑面上に流延または塗布し、乾燥等により溶剤を除去し、平滑面から剥離してフィルムを得る。乾燥により溶媒を除去する場合は、急速な乾燥により発泡することのない方法を選択することが好ましく、例えば、低温である程度溶媒を揮発させた後、温度を上げて溶媒を十分に揮発させるようにすればよい。

平滑面としては、鏡面処理した金属板や樹脂製のキャリアフィルム等を用いることができる。樹脂製のキャリアフィルムを用いる場合、キャリアフィルム素材の耐溶剤性や耐熱性に注意して、使用する溶媒や乾燥条件を決める。接着フィルムは、一般に、1μm~1mm程度の厚みを有する。

15 (接着方法)

本発明の接着剤を用いて、半導体部品と基板を接着する方法としては、例えば、(1) 基板表面に該接着剤溶液を塗布した後、溶媒を乾燥させて接着剤層を形成させ、該接着剤層に半導体部品を加熱・圧着させる方法、及び(2) 基板表面に該接着剤から作製した接着性フィルムを積層し、さらにその上に半導体部品を設置した後に、環構造含有熱可塑性重合体のガラス転移温度以上の温度で加熱・圧着し、しかる後に冷却する方法が挙げられる。

(1)接着剤を塗布する方法

接着剤を塗布する場合は、半導体部品をフリップチップボンディ 25 ングする際に、該半導体部品の電極が接続される基板上の全ての電 極を覆う状態で接着剤をコートする。接着剤のコート方法は、特に

10

20

25

限定されないが、基板上の限られた範囲に接着剤を均一な厚みで塗布できる方法として、例えば、スクリーン印刷、ディスペンサーによる方法、スピンコートによる方法等が好ましい。

また、接着剤の塗布は、基板側でなく、半導体チップの接着面でも構わない。塗布された接着剤は、加熱乾燥により溶媒が除去される。乾燥後の接着剤層は、半導体部品が実装された時の半導体素子と基板の隙間よりも厚くなっているのが好ましい。

以上のように形成された基板上の接着剤層上に、半導体部品を、環構造含有熱可塑性重合体のガラス転移温度以上の温度にて加熱・加圧することによって接着する。この際、該半導体部品の電極と基板の電極は完全に接触するか、導電性粒子を介して接触する。さらに接着剤層が半導体チップと基板の隙間に完全に充填することで、素子と基板の接着、及び電極の保護という2つの機能を発揮することができる。

15 (2)接着フィルムを使用する方法

接着フィルムを使用する方法は、塗布により形成された接着剤層の代わりに、前述の方法により予め形成した接着用フィルムを用いる。接着フィルムを接着の際に半導体部品と基板の間に挟み、ガラス転移温度以上の温度で加熱加圧することにより接着する。これ以外の方法は、塗布法による接着方法と同一である。

(半導体部品パッケージ)

前述の方法で、半導体部品と基板とがフリップチップボンディングされたものは、さらにマザーボードのプリント配線板に実装できるような電極を設置し、半導体パッケージやマルチ・チップ・モジュールとして、コンピュータや情報通信機器などに使用される。

,我们来到了了。""我们就是一个人,我们就是一个人。""我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是

20

< 実施例 >

以下に、実施例、比較例、及び合成例を挙げて本発明を具体的に 説明する。これらの実施例等において、「部」及び「%」は、特に 断りのない限り、重量基準である。

5 各種物性の測定法は、次のとおりである。

- (1)ガラス転移温度(Tg)は、示差走査熱量法(DSC法)により測定した。
- (2)数平均分子量(Mn)及び重量平均分子量(Mw)は、特に記載しない限り、トルエンを溶媒とするゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)によるポリスチレン換算値として測定した。
- (3)主鎖の水素添加率、ポリマーの変性率、及び共重合比率は、 ¹H-NMRにより測定した。変性率は、前記式(1)により算出した。
- 15 (4) 誘電率及び誘電正接は、JIS C 6 4 8 1 に準じて、1 M H z において測定した。
 - (5)接着強度は、接着剤を用いて、短冊状のガラスエポキシ基板 同士を190℃の加熱条件で接合(接着)した。接合面積は、20 ×20mmである。この接着サンプルを用いて、引張試験機によっ て、剪断強度を測定して、接着強度として表した。
 - (6)温度サイクル試験(TCT)は、前記接着サンプルを用い、 -55℃(30min)→室温(5min)→150℃(30min)
 →室温(5min)の温度サイクルを300回繰り返すことで温度 衝撃を加え、不良発生(剥離)の有無を調べた。
- 25 プレッシャークッカー試験 (PCT) は、湿度100%、105 ℃の環境下に300時間放置し、不良発生の有無を調べた。

いずれの場合も、以下の基準で評価した。

〇:不良発生あり、

×:不良発生なし。

[合成例1]

六塩化タングステン、トリイソブチルアルミニウム、イソブチル 5 アルコールを重合触媒として用い、公知の方法により8-エチルテ トラシクロ $[4.4.1^{2,5}.1^{7,10}.0]$ - 3 - ドデセン (以下、 ETDと略す)を開環重合した。得られた開環重合体を、ニッケル アセチルアセトナートとトリイソブチルアルミニウムを用いて、公 知の方法により水素添加し、ETDの開環重合体水素添加物(水素 10 化率≥99%、Tg=138℃、Mn=18,500、Mw=31, 600)を得た。この水素添加物100部に対して、アリルアルコー ル15部、ジクミルペルオキシド5部、tert-ブチルベンゼン 3 0 0 部を混合し、オートクレープ中にて、1 5 0 ℃、 4 時間反応 を行った後、反応液を300部のメタノール中に注ぎ、凝固させた。 15 凝固物を乾燥し、アルコール変性ポリマー(A)を得た。その合成 結果を表1に示した。

[合成例2]

アリルアルコール 1 5 部をトリメトキシビニルシラン 2 0 部に変 20 える以外は、合成例 1 と同様にしてシラン変性ポリマー (B) を得 た。このシラン変性ポリマーは、加水分解されると、シラノール基 を持つようになる。その合成結果を表 1 に示した。

[合成例3]

アリルアルコール 1 5 部を無水マレイン酸 2 部に変える以外は、 25 合成例 1 と同様にして無水マレイン酸変性重合体を得た。得られた 重合体 1 0 0 部に対して、水 1 部及びトリエチルアミン 1 部を加え て、150℃で1時間加水分解反応を行い、マレイン酸変性重合体 (C)を得た。合成結果を表1に示した。

[合成例4]

アリルアルコール 1 5 部をアリルグリシジルエーテル (AGE) 1 5 部に変える以外は、合成例1 と同様にしてエポキシ変性重合体 (D) を得た。合成結果を表 1 に示した。

[合成例5]

10

15

20

25

[合成例6]

アリルアルコール 1 5 部をトリメトキシビニルシラン 2 0 部に変える以外は、合成例 5 と同様にしてシラン変性重合体 (F) を得た。合成結果を表1 に示した。

[合成例7]

アリルアルコール 1 5 部を無水マレイン酸 2 部に変える以外は、 合成例 5 と同様にして無水マレイン酸変性重合体を得た。得られた 重合体 1 0 0 部に対して、水 1 部及びトリエチルアミン 1 部を加え て、 1 5 0 ℃で 1 時間加水分解反応を行い、マレイン酸変性重合体 (G)を得た。合成結果を表 1 に示した。

[合成例8]

アリルアルコール15部をアリルグリシジルエーテル15部に変える以外は、合成例5と同様にしてエポキシ変性重合体(H)を得た。合成結果を表1に示した。

5 [合成例9]

特開平7-258318号公報に記載されているLi系リビングアニオン重合触媒 [n-BuLi/テトラメチレンジアミン(TMEDA:リビングアニオン安定化剤)=1/1(モル比)〕を用いて、1、<math>3-シクロヘキサジエン(C-HD)を重合して1、4-付加型重10合体を得た。次いで、この付加型重合体を水素添加して、水素添加物(水素化率 $\geq 99\%$ 、Tg=219%、Mn=53,400、Mw=78,000)を得た。

得られた水素化重合体 1 0 0 部に対して、アリルアルコール 1 5 部、ジクミルペルオキシド 5 部、 t e r t ー ブチルベンゼン 3 0 0 部を混合し、オートクレーブ中にて 1 5 0 ℃、 4 時間反応を行った後、反応液を上記と同様にして凝固、乾燥し、アルコール変性重合体(I)を得た。それぞれの物性を表 1 に示した。

[合成例10]

15

アリルアルコール 1 5 部をトリメトキシビニルシラン 2 0 部に変 20 える以外は、合成例 5 と同様にしてシラン変性重合体 (J) を得た。 合成結果を表1 に示した。

[合成例11]

アリルアルコール15部を無水マレイン酸2部に変える以外は、 合成例9と同様にして無水マレイン酸変性重合体を得た。得られた 25 重合体100部に対して、水1部及びトリエチルアミン1部を加え て、150℃で1時間加水分解反応を行い、マレイン酸変性重合体 (K)を得た。合成結果を表1に示した。

[合成例12]

アリルアルコール 1 5 部をアリルグリシジルエーテル 1 5 部に変える以外は、合成例 9 と同様にしてエポキシ変性重合体 (L) を得た。合成結果を表1 に示した。

[合成例13]

数平均分子量(Mn)が9,200のポリ(2,6ージメチルー1,4ーフェニレンエーテル:PPE)100部と、無水マレイン酸1.5部、及び2,5ージメチルー2,5ージ(tーブチルパーオキシ)へキサン(日本油脂㈱製パーへキサ25B)1.0部を室温でドライブレンドした後、シリンダー温度300℃、スクリュー回転数230rpmの条件で2軸押出機により押し出して、無水マレイン酸変性ポリフェニレンエーテル(PPE)(G)を得た。その合成結果を表1に示した。

15

10

5

			ロ ボ	A	m	ပ		田田	ഥ	ß	H	-		×	1	M
			誘電 正接 (tan S)	0.001	0.001	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.0007	0.001	0.01
5			誘電率 (E)	2.45	2.34	2.38	2.41	2.38	2.36	2.37	2.40	2.38	2.34	2.40	2.40	3.05
		1 2	吸水率 (%)	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.10
		変性ポリマ	Mw (×10')	3.19	3.36	2.91	2.99	3.74	3.87	3.41	3.72	7.99	0.95	2.79	1.54	1.54
10		数	Mn Mw (×10') (×10')	1.75	1.81	1.77	1.75	1.44	1.43	1.42	1.52	4.92	0.55	1.68	0.85	0.85
10			Tg (°C)	140	131	154	150	135	129	148	145	220	207	225	223	183
			変性率 (51%)	8	11	2	7	8	6	2	9	6	8	2	5	1
	表		変性基	71-511	4-156	74/7酸	工件沙	11-5117	1-1-1V	71/7酸	工术本沙	71-CA17	4-15%	71/7酸	工作社	邓沙酸
15			Mw (×10')	3.16	3.16	3.16	3.16	3.56	3.56	3.56	3.56	7.80	7.80	7.80	7.80	1.33
	:		Mn (×10°)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.52	1.52	1.52	1.52	5.34	5.34	5.34	5.34	0.92
		1,	Tg (°C)	138	138	138	138	135	135	135	135	219	219	219	219	178
20		ቶሀ구	水添率 (%)	66 ₹	66 ₹	66 ₹	89 ≤	. !	Į	ı	ı	≥ 99	66 ₹	≥ 99	≥ 99	ı
			重合方式	開環	開環	開環	開環	付加	付加	付加	付加	付加	付加	付加	付加	ı
			額 成 (切比)	ETD	ETD	ETD	ETD	TCD/151/ (38/62)	TCD/15V7 (38/62)	TCD/15V7 (38/62)	TCD/15V7 (38/62)	C-ID	(C-ID)	C-E	C-10	PPE
25				合成例1	合成例2	合成例3	合成例4	合成例5	合成例6	合成例7	合成例8	合成例9	合成例 10	合成例11	合成例12	合成例 13

(脚注)

- (1) ETD:エチルテトラシクロドデセン
- (2) TCD: テトラシクロドデセン
- (3) C-HD:1, 3-シクロヘキサジエン
- 5 (4) PPE: ポリフェニレンエーテル

[実施例1~17]

合成例 1 ~ 1 3 で得られた各重合体に、それぞれシリカ粒子(粒径 0 . 0 1 μm)及びビスフェノールF型エポキシ樹脂を表 2 に示した配合比で添加し、これを樹脂成分量が 3 0 % となるようにキシレンに溶解した。さらに、導電性粒子としてハンダ粒子を、基材高分子 1 0 0 重量部に対して、3 重量部配合した。得られた溶液をスピンコーターを用いて厚さ 3 mmのポリテトラフルオロエチレン板上で 6 0~ 7 0 μmに薄膜化し、1 5 0 ℃×1時間窒素中で乾燥させた。このフィルムの作成時、及び 6 カ月間保存後の接着強度を表 2 に示した。

また、得られたフィルムをガラスエポキシ基板上に置き、その上からシリコンを基体とする半導体部品(100μmピッチ、360ピン)を190℃×5秒間加熱、圧着して接合した。そして、この試料の作成時、及び6ヶ月後の温度サイクル試験(TCT)、及びプレッシャークッカー試験(PCT)における不良発生の有無を調べた。評価結果を表2に示したが、いずれの試料も優れた結果を示した。

[実施例18]

20

基材高分子として、官能基含有ノルボルネン系開環重合体水素添25 加物(日本合成ゴム社製ARTON、Mn=17,600、Mw=57,700、フーリエ変換赤外分光法によりエステル結合による

カルボニルの吸収を確認、Tg=171℃、吸水率0.2%、誘電率:3.24、誘電正接:0.022)を用いて、表2に示した配合比で接着剤組成物と試料を作成し、実施例1~17と同様に作成時及び6ヶ月保存後の接着強度の測定、温度サイクル試験、プレッシャークッカー試験を実施し、問題ないことを確認した。結果を表2に示す。

[比較例1~3]

接着剤の主剤(基材高分子)として、ビスフェノールF型エポキシ樹脂を用い、これに硬化剤として2-エチル-4-メチルイミダゾールを5部添加して接着剤を調製した。そして、表2に示した接合条件で、実施例1~18と同様に、接着強度の測定、温度サイクル試験、プレッシャークッカー試験を実施した。その結果、満足のいくものは、硬化時間を60秒としたものだけであった。したがって、エポキシ樹脂は、硬化速度が遅く、生産性に問題があった。また、6ヶ月間保存後に同様の試験をしようとしたが、試料が完全に硬化していた。

5

10

PCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 フィルム6カ月後 TCT 0 0 O \bigcirc 0 \bigcirc 0 0 0 0 0 \bigcirc 0 0 接着強度 (kg/cm²) 105 110 100 140 100 125 100 100 130 100 105 90 95 5 PCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 フィルム作成時 TCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 接着強度 (kg/cm²) 105 110 100 100 135 135 100 100 120 100 100 95 95 95 10 (金融) വ S 2 接合条件 S വ S വ S S S വ വ S S 温(2) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 6 2 表 然加量 (部) 20 20 20 23 ಜ 1 ಜ 20 23 20 1 1 8 15 配合剤 エポキシ エポキシ エポキン エポキツ エポキシ エポキシ エポキジ 種類 ** ** # ١ i ı H H 然加量 (部) 8 8 2 20 ಜ 1 1 1 I 2 8 ಜ 20 充填剤 シリカ シリカ シリカ シリカ シリカ シリカ シリカ ħ カ カ 種類 20 ツー グラ 1 ł 1 1 $\overline{}$., B(100) C(100) D(100) F(100) A(100) A(100) B(100) C(100)E(100) G(100)D(100) H(100)I(100)J(100)V 鍋 7 4 実施例11 実施例 10 **実施例12** 実施例 13 **実施例14** 実施例3 実施例5 実施例6 実施例4 実施例8 実施例2 実施例7 実施例9 実施例1

. 2 (結本)

				-			-						
	ነ = =	充填剤	割	配合剤	秦	接合	接合条件	711	フィルム作成時	盘	フィルム6カ月後	467E	後
·	(部)	種類	然加量 (部)	種類	添加量 (部)	温度 (°C)	(4) 開報	接着強度 (kg/cm²)	TCT	PCT	接着強度 (kg/cm²)	TCT	PCT
実施例15	K(100)	シリカ	20	エポキシ	20	190	5	125	0	0	125	0	0
実施例 16	L(100)	シリカ	20	エポキシ	20	190	5	06	0	0	06	0	0
実施例17	M(100)	シリカ	50	エポキツ	20	190	5	75	0	0	80	0	0
実施例18	ARTON (100)	シリカ	40	エポキシ	20	190	5	120	0	0	120	0	0
比較例1	エポキシ (100)	シリカ	20	2E4MZ	ည	190	5	10	×	×	ı	×	×
比較例2	エポキシ (100)	シリカ	20	2E4MZ	ည	190	30	02	×	×	1	×	×
比較例3	エポキシ (100)	シリカ	20	2E4MZ	ى ئ	190	09	150	0	0	ı	×	×

(脚注)

- (1) エポキシ: ビスフェノールF型エポキシ樹脂
- (2) 2 E 4 M Z : 2 エチル-4 メチルイミダゾール

5 [実施例19]

10

25

合成例1で得られた重合体(A)100部に対して、表3に示した配合比で平均粒径7μmのNi粒子(導電性フィラー①)を添加し、これを樹脂成分量が30%となるようにキシレンに溶解した。この溶液を用いて、厚さ50~70μmのシートを作製した。得られたシートをガラスエポキシ基板上に置き、その上からシリコンを基体とする半導体部品(125μmピッチ、360ピン)を200℃×30秒間加熱、圧着して接合した。この試料の高温高湿試験を行った。評価結果を表3に示したが、優れた結果を示した。なお、高温高湿試験の方法は、表3の後に示す。

15 [実施例20~23]

表3に示す各重合体と導電性フィラーを、表3に示す配合割合で用いたこと以外は、実施例19と同様にしてシートを作製し、高温高湿試験を行った。評価結果を表3に示したが、いずれの試料の優れた結果を示した。

20 [実施例24]

平均粒径 7 μ m の N i 粒子にアクリル/スチレン樹脂を 5 : 1 0 0 の割合で混合して、ハイブリタイゼーションシステム(奈良機械社製)を用いて回転数 1 6 2 0 0 r p m で 1 0 分間処理することにより N i 粒子に厚さ 0 . 1 ~ 0 . 2 μ m の被膜を形成したマイクロカプセル型導電性フィラー④を得た。

この導電性フィラー④を用いたこと以外は、実施例19と同様に

WO 99/01519 PCT/JP98/03033

してシートを作製し、高温高湿試験を行った。評価結果を表 3 に示したが、優れた結果を示した。

[実施例25]

5

2 j.

10

15

平均粒径 5 μ m のシリカに N i / A u メッキを施した粒子を用いて、実施例 2 4 と同様にして、厚さ 0 . 1 ~ 0 . 2 μ m のアクリル / スチレン樹脂被膜を形成したマイクロカプセル型導電性フィラー ⑤を得た。

この導電性フィラー⑤を用いたこと以外は、実施例19と同様に してシートを作製し、高温高湿試験を行った。評価結果を表3に示 したが、優れた結果を示した。

[実施例26]

平均粒径 5 μ m のベンゾグアナミン樹脂(日本化学社製、ブライト 2 0 G N R Y 4 . 6 E H)にN i / A u メッキを施した粒子を用いて、実施例 2 4 と同様にして、厚さ 0 . 1 ~ 0 . 2 μ m のアクリル/スチレン樹脂被膜を形成したマイクロカプセル型導電性粒子⑥を得た。

この導電性フィラー⑥を用いたこと以外は、実施例19と同様に してシートを作製し、高温高湿試験を行った。評価結果を表3に示 したが、優れた結果を示した。

20 [比較例4~6]

トルエン80重量部に、エポキシ樹脂(エピコート1009、油化シェルエポキシ社製)100重量部、硬化剤としてHX3941HP (旭化成社製)170重量部を添加し、エポキシ樹脂ワニスを作製した。

25 このエポキシ樹脂ワニスに、表3に示す導電性フィラーを配合し、 実施例19と同様にして半硬化状態のシートを作製した。このよう にして作製したハードベーク前のシートを用いて、実施例19と同様にガラスエポキシ基板上に半導体部品を圧着した。評価結果を表3に示したが、いずれも高温高湿試験後の接続抵抗値が50Ω以上であり、導通不良となった。

5

10

表 3

	ポリ	リマー	導電性フ	ィラー	高温高	湿試験
	((部)	種類	(部)	初期	1000時間
実施例 19	Α	(100)	1	20	0	0
実施例 20	С	(100)	2	5	· ©	0
実施例 21	С	(100)	3	5	0	0
実施例 22	E	(100)	①	20	0	0
実施例 23	J	(100)	1	20	0	0
実施例 24	Α	(100)	4	20	0	0
実施例 25	Α	(100)	5	20	©	©
実施例 26	A	(100)	6	20	©	©
比較例4	エボキシ	(100)	1	20	0	×
比較例5	エポキシ	(100)	2	5	0	×
比較例6	エポキシ	(100)	3	5	0	×

15

(脚注)

(1)高温高湿試験は、サンプルを湿度100%、温度105℃の環境下に1,000時間放置し、接続抵抗値の上昇の度合を調べ、以下の基準で評価した。

<初期>

◎:10Ω以下、

〇:20Ω以下、

25 Δ:30Ω以下、

×:50Ω以上。

WO 99/01519 PCT/JP98/03033

51

< P C T 後 >

◎:10Ω以下、

〇:20Ω以下、

Δ:30Ω以下、

×:50Ω以上。 5

(2) 導電性フィラー

導電性フィラー①:平均粒径7μmのNi粒子

導電性フィラー②:平均粒径 5 μ mのシリカにNi/Auメッキを 施した粒子

導電性フィラー③:平均粒径 5 μ m のベンゾグアナミン樹脂 (日本 10 化学社製、ブライト20GNRY4.6EH)にNi/Auメッキ を施した粒子

導電性フィラー④:マイクロカプセル型導電性フィラー

導電性フィラー⑤:マイクロカプセル型導電性フィラー

導電性フィラー⑥:マイクロカプセル型導電性フィラー 15

<産業上の利用可能性>

20

25

本発明によれば、特に半導体部品のフリップチップボンディング に適した、保存安定性、生産性、強度特性、耐熱性に優れた接着剤 及び該接着剤を用いた電子部品パッケージが提供される。本発明の 接着剤は、誘電率や誘電正接などの電気特性、及び耐湿性に優れ、 しかも、半導体チップや実装基板などとの接着性に優れる。本発明 の半導体部品接着剤は、電気・電子機器分野において特に高速性、 高信頼性の要求される半導体パッケージ用接着剤などとして、広範 な分野において有用である。

請求の範囲

- 1. (a)環状オレフィン系重合体及び(b)主鎖中に芳香環の繰り返し単位を有する芳香族縮合系重合体からなる群より選ばれる少なくとも一種の数平均分子量が1,000~500,000環構造含有熱可塑性重合体を基材高分子とする半導体部品接着剤。
- 2. 環構造含有熱可塑性重合体が、該重合体の総モノマー数を基準として、5~100モル%の官能基を有するものである請求項 10 1記載の半導体部品接着剤。
 - 3. 官能基が、アルコール基、エポキシ基、カルボキシル基、酸無水物基、またはシラノール基である請求項2記載の半導体部品接着剤。

15

20

- 4. 環状オレフィン系重合体(a)が、(1) ノルボルネン環を有する脂環族単量体の付加(共)重合体、(2) ノルボルネン環を有する脂環族単量体とビニル化合物との付加共重合体、(3) ノルボルネン環を有する脂環族単量体の開環(共)重合体、及び(4) ノルボルネン環を有する脂環族単量体の開環(共)重合体の水素添加物からなる群より選ばれる少なくとも一種の熱可塑性ノルボルネン系樹脂である請求項1または2に記載の半導体部品接着剤。
- 5. 環状オレフィン系重合体(a)が、環状共役ジェンの付加 25 重合体、及び該付加重合体の水素添加物からなる群より選ばれる少 なくとも一種である請求項1または2に記載の半導体部品接着剤。

- 6. 芳香族縮合系重合体(b)が、ポリフェニレンエーテルである請求項1または2に記載の半導体部品接着剤。
- 7. 芳香族縮合系重合体 1 0 0 重量部に対して、非導電性の無 機フィラー 1 ~ 1 0 0 重量部を含有する樹脂組成物からなる請求項 1 または 2 に記載の半導体部品接着剤。
- 8. 芳香族縮合系重合体 1 0 0 重量部に対して、導電性フィラー 1 ~ 1 0 0 重量部を含有する樹脂組成物からなる請求項 1 または 2 に記載の半導体部品接着剤。
 - 9. 異方性導電材である請求項8記載の半導体部品接着剤。
- 10. 芳香族縮合系重合体100重量部に対して、低分子量樹 15 脂1~50重量部を含有する樹脂組成物からなる請求項1または2 に記載の半導体部品接着剤。
 - 11. 芳香族縮合系重合体のガラス転移温度が100℃以上である請求項1記載の半導体部品接着剤。
 - 12. 環状オレフィン系重合体(a)が、テトラシクロドデセン類の開環共重合体の水素添加物、テトラシクロドデセン類とビニル化合物との付加共重合体、または1,3-シクロヘキサジエンの付加重合体の水素添加物を、官能基含有不飽和化合物によりグラフト変性して官能基を導入した変性ポリマーである請求項2記載の半導体部品接着剤。

- 13. 非導電性の無機フィラーが、シリカである請求項7記載の半導体部品接着剤。
- 14. 低分子量樹脂が、エポキシ樹脂である請求項10記載の 5 半導体部品接着剤。
 - 15. 芳香族縮合系重合体 100重量部に対して、充填剤 1~ 100重量部、及び低分子量樹脂 1~50重量部を含有する樹脂組 成物からなる請求項 1または 2 に記載の半導体部品接着剤。

- 16. 請求項1ないし15のいずれか1項に記載の接着剤を製膜してなる半導体部品接着フィルム。
- 17. 請求項1ないし15のいずれか1項に記載の接着剤の溶 15 液またはフィルムを用いて、半導体部品と基板とを接合させてなる 半導体部品パッケージ。
- 18. 基板表面に請求項16記載の接着フィルムを積層し、次いで、該接着フィルムの上に半導体部品を設置した後、環構造含有 20 熱可塑性重合体のガラス転移温度以上の温度で加熱・加圧することにより接着し、しかる後、冷却することを特徴とする半導体部品パッケージの製造方法。
- 19. 基板表面に請求項1ないし15のいずれか1項に記載の 25 接着剤の溶液を塗布した後、溶媒を乾燥させて接着層を形成し、次 いで、該接着層の上に半導体部品を設置した後、環構造含有熱可塑

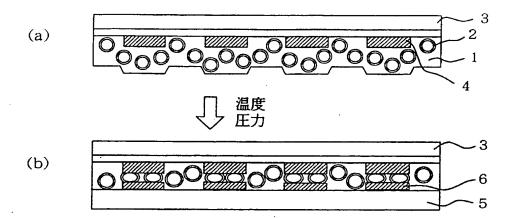
WO 99/01519 PCT/JP98/03033

性重合体のガラス転移温度以上の温度で加熱・加圧することにより接着し、しかる後、冷却することを特徴とする半導体部品パッケージの製造方法。

A(20 0)	. d				wijk ta i i i
				,	la de
•					
10 To 10 m			*		
	\$\$. 1				
					· ·
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
24			e ^y		
	*				
	• * *	•		n in the second second	
	• 64.	*			
					₩
					4.7 ·
	x .		- 140		
•		*			
			and the state of t	S. S. Santara C.	
			*		
		,			
		ej visit og till. Historija je je sa je se			ty garage
.		A to the grown of the state of			
	*			440	
					·
•					
		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
			* *		*
(). ()	•			. *	
B. 4.					
And		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	er Sparker	

1/1

図 1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/03033

A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .Cl ⁶ C09J123/26, 165/00, 171/1 (C09J165/00, 163:00), (C0	12, H01B1/20 // (C09J12	3/26, 163:00),	
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both r			
B. FIELD	S SEARCHED			
Int.	locumentation searched (classification system followed C1 C09J123/00-123/36, 165/00 H01B1/20-1/24), 171/08-171/14, 163/0		
	tion searched other than minimum documentation to the			
Electronic d	lata base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, s	earch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		- 4	
Category*	Citation of document, with indication, where an	, ,	Relevant to claim No.	
Е, Х	JP, 10-241461, A (Asahi Che Co., Ltd.), 11 September, 1998 (11. 09. Claims; Examples 1, 2 (Fam.	98),	1, 7-8, 10-11, 13-19	
E, Y E, A		·	9 2-6, 12	
E, X	JP, 10-251606, A (Asahi Cher Co., Ltd.), 22 September, 1998 (22. 09. Claims; Examples 1, 2 (Fam.	98),	1, 7-8, 10-11, 13-19	
E, Y E, A				
У А	<pre>JP, 62-243668, A (Matsushita Co., Ltd., et al.), 24 October, 1987 (24. 10. 87 Claims (Family: none)</pre>		9 1-8, 10-19	
× Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
"A" docume consider "E" earlier d docume cited to special a docume means "P" docume the prior	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not ed to be of particular relevance locument but published on or after the international filing date nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other int published prior to the international filing date but later than rity date claimed cetual completion of the international search eptember, 1998 (29. 09. 98)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report		
Name and m	ailing address of the ISA/	13 October, 1998 (
_	nese Patent Office	Tolombono No.		
Facsimile No).	Telephone No.	1	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/03033

A JP, 3-95286, A (Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.), 19 April, 1991 (19. 04. 91), Claims (Family: none) A JP, 4-288342, A (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.), 13 October, 1992 (13. 10. 92), Claims (Family: none) A JP, 8-239642, A (Asahi Chemical Industry Co., Ltd.), 17 September, 1996 (17. 09. 96), Claims (Family: none)	ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Claims (Family: none) A JP, 8-239642, A (Asahi Chemical Industry Co., Ltd.), 17 September, 1996 (17. 09. 96), Claims (Family: none)		JP, 3-95286, A (Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.), 19 April, 1991 (19. 04. 91),	
17 September, 1996 (17. 09. 96), Claims (Family: none)	A	13 October, 1992 (13. 10. 92),	1-19
	A	17 September, 1996 (17. 09. 96),	1-19
			·
	·		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		·	·
į			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際出願番号 PCT/JP98/03033

Int. Cl. 6	国する分野の分類(国際特許分類(IPC)) C09J 123/26, 165/00, //(C09J 123/26, 163:00) (C09J 171/12, 163:00)		0),
B. 調査を行			
調査を行った最	B小限資料 (国際特許分類 (IPC)) CO9J 123/00-123/36, 163/00-163/10, HO1B 1/20-1/24	165/00, 171/08-171/1	4,
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
E, X E, Y E, A	JP, 10-241461, A () 11. 9月. 1998 (11. 0) 特許請求の範囲, 実施例1, 2 (ファミリーなし)	但化成工業株式会社), 9.98),	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
X C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」先行文 の の の を を を を を を を で の で を を さ で の で を を さ で の で を を さ で の で を は す と し で り で り で り で り で り で し で り で し で し で	のカテゴリー 極のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 式ではあるが、国際出願日以後に公表されたも 三張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献 で出願と矛盾するものではなく、論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、当上の文献との、当業者にとってはよって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理 経該文献のみで発明 たれるもの 経該文献と他の1以 間である組合せに
国際調査を完了	てした日 29.09.98	国際調査報告の発送日 13.10.5	8
日本国	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 『便番号100-8915 『千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 山 本 昌 広 電話番号 03-3581-1101	4 J 9 2 8 0 内線 3 4 5 9

C (続き).	関連すると認められる文献	·
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
E, X	JP, 10-251606, A (旭化成工業株式会社), 22. 9月. 1998 (22. 09. 98), 特許請求の範囲, 実施例1, 2 (ファミリーなし)	1, 7-8, 10-11, 13-19
E, A .		2-6, 12
Y A	JP, 62-243668, A(松下電器産業株式会社外1名), 24. 10月. 1987 (24. 10. 97), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	9 1-8, 10-19
A	JP, 3-95286, A(三井石油化学工業株式会社), 19. 4月. 1991(19. 04. 91), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1 -19
A	JP, 4-288342, A (日本合成ゴム株式会社), 13. 10月. 1992 (13. 10. 92), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1 —19
A	JP, 8-239642, A (旭化成工業株式会社), 17. 9月. 1996 (17. 09. 96), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1 -19
		,
	·	

--

Docket No. 10936-38

<u>CERTIFICATE OF MAILING</u>

428 Rec'd PCT/PTO 0 4 TENT 2000

"Express Mail" mailing label #: EL528222655US

Date of Deposit: January 4, 2000

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to: Box PCT; Assistant Commissioner

for Patents; Washington, DC 2023 L

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Junji KODEMURA

Paper No.:

Based On:

PCT/JP98/03033

Group Art Unit:

Filing Date:

January 4, 2000

Examiner:

For: Adhesive for Semiconductor Part (as amended)

TRANSMITTAL OF ENGLISH LANGUAGE TRANSLATION OF ANNEXES TO THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

BOX PCT Assistant Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Dear Sir:

Submitted herewith an English language translation of the annex to the International Preliminary Examination Report, which corresponds with pages 71-73 of the application, together with an explanation of the amendments set forth in the annex. Entry of the annex is believed to be in order and is respectfully requested.

Respectfully submitted,

Holly D. Kozlowski(/

Registration No. 30,468

Dinsmore & Shohl LLP

1900 Chemed Center

255 East Fifth Street

Cincinnati, Ohio 45202

(513) 977-8568

AMENDMENT

(Amendment under the provisions of Article 11 of the Patent Law)

Dated: May 21, 1999

Hon. Commissioner of Patent Office

1. Indication of International Application: PCT/JP98/03033

2. Applicant:

Name:

NIPPON ZEON CO., LTD.

Address:

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-0005 Japan

Nationality: Japan

Domicile:

Japan

3. Agent:

Name:

NISHIKAWA Shigeaki, Patent Attorney

(Reg'n No. 9352)

Address:

Visual city 401, 43-8, Higashi-Nippori

3-chome, Arakawa-ku, Tokyo 116-0014 Japan

4. Subject of the Amendment:

Claims.

- 5. Details of the Amendment: See Appendixes
- (1) In the Claim 7, amend "aromatic-condensed polymer" to --cyclic structure-containing thermoplastic polymer--.
- (2) In the Claim 8, amend "aromatic-condensed polymer" to --cyclic structure-containing thermoplastic polymer--.
- (3) In the Claim 10, amend "aromatic-condensed polymer" to --cyclic structure-containing thermoplastic polymer--.
- (4) In the Claim 11, amend "aromatic-condensed polymer" to --cyclic structure-containing thermoplastic polymer--.
- (5) In the Claim 15, amend "aromatic-condensed polymer" to --cyclic structure-containing thermoplastic polymer--.
- 6. List of Appended Documents:
- (1) Substitute sheets for pages 53 and each one copy 54 (corresponding to pages 71 to 73 of its English version) in the claims

norbornene ring and a vinyl compound, (3) a ring-opening (co)polymer of an alicyclic monomer having a norbornene ring and (4) a hydrogenated product of the ring-opening (co)polymer of the alicyclic monomer having a norbornene ring.

5

10

- 5. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 1 or 2, wherein the cycloolefin polymer (a) is at least one selected from the group consisting of an addition polymer of a cyclic conjugated diene monomer and a hydrogenated product of the addition polymer.
- 6. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 1 or 2, wherein the aromatic-condensed polymer (b)

 15 is poly(phenylene ether).
- 7. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 1 or 2, which is composed of a resin composition comprising a non-conductive inorganic filler in a 20 proportion of 1 to 100 parts by weight per 100 parts by weight of the aromatic-condensed polymer.
- 8. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 1 or 2 which is composed of a resin composition
 25 comprising a conductive filler in a proportion of 1 to 100 parts by weight per 100 parts by weight of the aromatic-condensed polymer.

Replaced by Estable 34

- 9. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 8, which is an anisotropic conductive material.
- 10. The adhesive for semiconductor parts according to 5 Claim 1 or 2, which is composed of a resin composition comprising a low-molecular weight resin in a proportion of 1 to 50 parts by weight per 100 parts by weight of the aromatic-condensed polymer.
- 11. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 1, wherein the glass transition temperature of the aromatic-condensed polymer is at least 100°C.
- 12. The adhesive for semiconductor parts according to
 15 Claim 2, wherein the cycloolefin polymer (a) is a modified polymer obtained by graft-modifying a hydrogenated product of a ring-opening copolymer of tetracyclododecene or a derivative thereof, an addition copolymer of tetracyclododecene or a derivative thereof and a vinyl compound, or a hydrogenated product of an addition polymer of 1,3-cyclohexadiene with a functional group-containing unsaturated compound.
- 13. The adhesive for semiconductor parts according to 25 Claim 7, wherein the non-conductive inorganic filler is silica.

- 14. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 10, wherein the low-molecular weight resin is an epoxy resin.
- 5 15. The adhesive for semiconductor parts according to Claim 1 or 2, which is composed of a resin composition comprising, per 100 parts by weight of the aromatic-condensed polymer, 1 to 100 parts by weight of a filler and 1 to 50 parts by weight of a low-molecular weight resin.
 - 16. An adhesive film for semiconductor parts, which is obtained by forming a film from the adhesive according to any one of Claims 1 to 15.

17. A semiconductor part package obtained by bonding a semiconductor part to a substrate with a solution or film of the adhesive according to any one of Claims 1 to 15.

20

25

18. A process for producing a semiconductor part package, which comprises laminating the adhesive film according to Claim 16 on the surface of a substrate, placing a semiconductor part on the adhesive film, bonding the semiconductor part to the substrate by heating and pressurizing the adhesive film at a temperature not lower than the glass transition temperature of the cyclic

Replace I by asticle 34

特許協力条約

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/

PCT

国際予備審査報告

REC'D 22 OCT 1999

WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人

の書類	頁記号	ZE - 684		IPEA/4	16)を参照する	こと。		
	出願番号 「/JP	98/03033	国際出願日 (日.月.年) (06.07.98	優先日(日.月.年)	04.07.97		
国際和	寺許分類			00, C09J171/12, H01B1/2 0), (C09J165/00, 163:00		63:00)		
出願力	人(氏名)	又は名称)	日本ゼオ	ン株式会社				
1.	国際予	備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を	法施行規則第57条 (P	CT36条) の規]定に従い送付する。		
2.	この国	際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で _	4 ^-	ジからなる。			
	査	の国際予備審査報告には、「 機関に対してした訂正を含さ PCT規則70.16及びPCT 属書類は、全部で	む明細書、請求の範	囲及び/又は図面も添 号参照)		『/又はこの国際予備審		
3.	この国	際予備審査報告は、次の内						
	I E	国際予備審査報告の基礎	<u>\$</u>					
	п	優先権						
	Ⅲ							
	IV [発明の単一性の欠如						
	v E	の文献及び説明	する新規性、進歩性	又は産業上の利用可能	性についての見角	¥、それを裏付けるため		
	VII [国際出願の不備						
	VIII [国際出願に対する意見						
			<u> </u>					
国際	予備審査	の請求書を受理した日 14.01.99		国際予備審査報告を 05	作成した日 . 10.99			
名称》		先 国特許庁 (IPEA/JP 郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4		特許庁審査官(権限 安那 達		4 V 9 2 8 5		
	71.71		- · ·	電話番号 03-3	581-1101	内線 3483		

Ι.	<u>_</u>	際予備審査報	と告の	基礎		
1.	こ 応	の国際予備署 で答するために	季査報 こ提出	告は下記の出願書類に基 された差し替え用紙は、	づいて作成さ; この報告書に	れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とする)
		出願時の国際	常出願	書類		·
	X	明細書 明細書 明細書 明細書	第 _	1-51	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時のもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 .	7, 8, 10, 11, 15		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 21.05.99 付の書簡と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	X	図面 図面 図面 図面	第第第第	1	_図、 _ページ/図、 _ページ/図、 _ページ/図、	付の書簡と共に提出されたもの
2.		明細書	第 .)書類が削除された。	ページ 項 ページ/図	
3		この国際予	備審査 その神	E報告は、補充欄に示した 創正がされなかったものと	こように、補正 として作成した	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら。 (PCT規則70.2(c))
4.	i	追加の意見(必要な	たらば)		
						•
				,		
						·

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP98/03033

国际了湘街 工 報台		四郎山城田 タード ロー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー	
新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	生についての法第12条	e(PCT35条(2))に定める見解 	、それを裏付け
. 見解			
•			
新規性(N)	請求の範囲 _. 請求の範囲	1-19	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-19	
	明水ツ軽四。		
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲		
	請求の範囲		
. 文献及び説明			
	ラ吹卵 木却 化 たよい 、 で 3	リロナシャケ枠に記載された発明で	ナカノ また
請求の範囲1-19に記載された発明は、『 の文献の記載から当業者が容易に発明をする。			はなく、また、
の人間の記載がり当来者が一番初に元列とする		0.21	
,			

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP98/03033

15

VI. ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 ———特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 _(日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
JP, 10-241461, A (E, X)	11.09.98	27.02.97	
JP, 10-251606, A (E, X)	22.09.98	10.03.97	

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
	(日.月.年)	書面の日付(日.月.年)

つCI/JP 98/03033 日本国特許庁 21.05.99

- 6. 芳香族縮合系重合体(b)が、ポリフェニレンエーテルである請求項1または2に記載の半導体部品接着剤。
- 7. (補正後) 環構造含有熱可塑性重合体 100重量部に対し 5 て、非導電性の無機フィラー 1~100重量部を含有する樹脂組成 物からなる請求項 1 または 2 に記載の半導体部品接着剤。
- 8. (補正後) 環構造含有熱可塑性重合体 100重量部に対して、導電性フィラー 1~100重量部を含有する樹脂組成物からな 10 る請求項 1 または 2 に記載の半導体部品接着剤。
 - 9. 異方性導電材である請求項8記載の半導体部品接着剤。
- 10. (補正後) 環構造含有熱可塑性重合体100重量部に対 15 して、低分子量樹脂1~50重量部を含有する樹脂組成物からなる 請求項1または2に記載の半導体部品接着剤。
 - 11. (補正後) 環構造含有熱可塑性重合体のガラス転移温度が100℃以上である請求項1記載の半導体部品接着剤。

20

25

7

12. 環状オレフィン系重合体(a)が、テトラシクロドデセン類の開環共重合体の水素添加物、テトラシクロドデセン類とビニル化合物との付加共重合体、または1,3-シクロヘキサジエンの付加重合体の水素添加物を、官能基含有不飽和化合物によりグラフト変性して官能基を導入した変性ポリマーである請求項2記載の半導体部品接着剤。

- 13. 非導電性の無機フィラーが、シリカである請求項7記載の半導体部品接着剤。
- 14. 低分子量樹脂が、エポキシ樹脂である請求項10記載の 5 半導体部品接着剤。
- 15. (補正後) 環構造含有熱可塑性重合体100重量部に対して、充填剤1~100重量部、及び低分子量樹脂1~50重量部を含有する樹脂組成物からなる請求項1または2に記載の半導体部10 品接着剤。
 - 16. 請求項1ないし15のいずれか1項に記載の接着剤を製膜してなる半導体部品接着フィルム。
- 15 17. 請求項1ないし15のいずれか1項に記載の接着剤の溶液またはフィルムを用いて、半導体部品と基板とを接合させてなる半導体部品パッケージ。
- 18. 基板表面に請求項16記載の接着フィルムを積層し、次 20 いで、該接着フィルムの上に半導体部品を設置した後、環構造含有 熱可塑性重合体のガラス転移温度以上の温度で加熱・加圧すること により接着し、しかる後、冷却することを特徴とする半導体部品パッケージの製造方法。
- 25 19. 基板表面に請求項1ないし15のいずれか1項に記載の接着剤の溶液を塗布した後、溶媒を乾燥させて接着層を形成し、次いで、該接着層の上に半導体部品を設置した後、環構造含有熱可塑



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference ZE-684	FOR FURTHER A		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP98/03033	1	ate (day/month/year) (06.07.1998)	Priority date (day/month/year) 04 July 1997 (04.07.1997)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C09J 123/26, 165/00, 171/12, H01B 1/20 // (C09J 123/26, 163:00) (C09J 165/00, 163:00) (C09J 171/12, 163:00)				
Applicant NIPPON ZEON CO., LTD.				
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 				
 This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 				
These annexes consist of a total of sheets.				
3. This report contains indications relating to the following items:				
Basis of the report			11 27	
II Priority	- 6 i - i i - i		NEC 1700	
Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability— Lack of unity of invention Lack of unity of invention		nep and industrial application by		
Reasoned statemen	atement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability,			
citations and explanations supporting such statement VI Certain-documents cited		<i>¥</i> ∃		
VII Certain defects in the	ects in the international application			
VIII Certain observations on the international application ON THE COMMAND A 21 PER 12 PER 1				
Date of submission of the demand		Date of completion o	f this report	
14 January 1999 (14.01.	1999)	05 O	ctober 1999 (05.10.1999)	
Name and mailing address of the IPEA/JP Japanese Patent Office, 4-3 Kasumigas Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	eki 3-chome	Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No. (81-3) 3581 1101		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP98/03033

I. Basis of the report						
1. This r under	report Article	has been drawn of e 14 are referred to	on the basis	s of (Replacement sheet. rt as "originally filed"	s which have been furnished to the and are not annexed to the repo	e receiving Office in response to an invitation ort since they do not contain amendments.):
		the international	applicatio	n as originally filed.		
[\boxtimes	the description,	pages	1-51	_, as originally filed,	
			pages		, filed with the demand,	
			pages		, filed with the letter of	,
			pages		_, filed with the letter of	
	\boxtimes	the claims,	Nos	1-6,9,12-14,16-19	_, as originally filed,	
•					, as amended under Article 1	9,
	**		Nos		, filed with the demand,	
			Nos	7,8,10,11,15	, filed with the letter of	21 May 1999 (21.05.1999)
						·
[\boxtimes	the drawings,	sheets/fig	51	, as originally filed,	
			sheets/fig		, filed with the demand,	
			sheets/fig	i	, filed with the letter of	,
			sheets/fig	;	, filed with the letter of	·
2. The ar	mendr	ments have resulte	ed in the ca	ancellation of:		
1		the description,	pages			
		the claims,	Nos			
	\Box	the drawings,				
	_					
3.	This	report has been es	stablished a	as if (some of) the am	endments had not been made, Supplemental Box (Rule 70.2	since they have been considered
	io go	Deyona the diserc)Sure as m	ed, as mulcated in the	: Supplemental бох (Кије 70.2	(c)).
4. Additi	onal o	observations, if ne	ecessary:			
			e ./s			

International application No.

PCT/JP98/03033

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

atement			
Novelty (N)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO.
Industrial applicability (IA)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The subject matters of claims 1-19 are neither described in any of the documents cited in the ISR, nor could have been easily conceived by a person skilled in the art from those documents.

International application No.

PCT/JP98/03033

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

VI. Certain documents cited

Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim (day/month/year)
11 September 1998 (11.09.1998)	27 February 1997 (27.02.1997)	
22 September 1998 (22.09.1998)	10 March 1997 (10.03.1997)	
on No. No. 1461, A X) 1606, A X)	No. (day/month/year) 1461, A 11 September 1998 (11.09.1998) X) 1606, A 22 September 1998 (22.09.1998)	No. (day/month/year) (day/month/year) 1461, A 11 September 1998 (11.09.1998) 27 February 1997 (27.02.1997) X) 1606, A 22 September 1998 (22.09.1998) 10 March 1997 (10.03.1997)

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

Kind of non-written disclosure

Date of non-written disclosure (day/month/year)

Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)





PCT

EP (

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 ZE-684	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP98/03033	国際出願日 (日.月.年) 06.07.98 優先日 (日.月.年) 04.07.97
出願人 (氏名又は名称)	日本ゼオン株式会社
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	査報告を法施行規則第41条 (PCT18条) の規定に従い出願人に送付する。 5。
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。
この調査報告に引用された先行技	支術文献の写しも添付されている。
1. 請求の範囲の一部の調査が	ができない(第1欄参照)。
2. 発明の単一性が欠如してい	ゝる(第Ⅱ欄参照)。
3. □ この国際出願は、ヌクレス 査を行った。	トチド及び/又はアミノ酸配列リストを含んでおり、次の配列リストに基づき国際調
□ この国際出願と共に提出	されたもの
出願人がこの国際出願と	:は別に提出したもの
しかし、出願時のほ	国際出願の開示の範囲を越える事項を含まない旨を記載した書面が添付されていない
□ この国際調査機関が書榜	きえたもの
 4. 発明の名称は X 出願	頂人が提出したものを承認する。
<u> </u>	- 示すように国際調査機関が作成した。
	TO DE LINE LINE TO THE OFFICE OF THE OFFICE
5. 要約は 🗶 出願	人が提出したものを承認する。
国界	「欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により
6. 要約書とともに公表される図は、	-
	i人が示したとおりである。 X なし
□ 出願	人は図を示さなかった。
	は発明の特徴を一層よく表している。



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. CO9J 123/26, 165/00, 171/12, H01B 1/20 //(C09J 123/26, 163:00), (C09J165/00, 163:00), (C09J 171/12, 163:00)				
	「Tった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC)) CO9J 123/00-123/36, 163/00-163/10, HO1B 1/20-1/24	165/00, 171/08-171/	1 4,	
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	*		٠.	
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	、調査に使用した用語)	26	
	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
E, X E, Y E, A	JP, 10-241461, A() 11. 9月. 1998 (11. 0 特許請求の範囲, 実施例1, 2 (ファミリーなし)	旭化成工業株式会社), 9.98),	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	-			
区 I C 脚の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了	した日 29.09.98	国際調査報告の発送日 13.10.9	98	
日本国	O名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 『便番号100-8915 『千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 山 本 昌 広 電話番号 03-3581-1101	4 J 9 2 8 0 内線 3 4 5 9	

			<u> </u>
<u>, </u>	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP9	8/03033
C (続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	ナーその関連する第両の表示	関連する 請求の範囲の番号
E, X E, Y E, A	JP, 10-251606, A(旭化成22.9月.1998(22.09.9 特許請求の範囲,実施例1,2 (ファミリーなし)	丁業株式会社)	1, 7-8, 10-11, 13-19 9 $2-6, 12$
Y A	JP, 62-243668, A(松下電器 24.10月.1987(24.10. 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	器産業株式会社外1名), 97),	$ \begin{array}{c} 9 \\ 1-8, \\ 10-19 \end{array} $
A	JP, 3-95286, A(三井石油化 19. 4月. 1991(19.04.9 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	学工業株式会社), 1),	1 —19
A	JP, 4-288342, A(日本合成 13.10月.1992(13.10. 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	ゴム株式会社), 92),	1 - 19
A	JP,8-239642,A(旭化成工 17.9月.1996(17.09.9 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	業株式会社), 6),	1 -19
			· •
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		